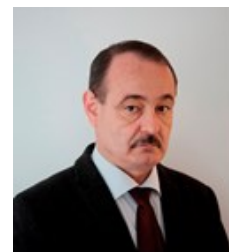


Curriculum vitae Europass

Informații personale

Nume / Prenume

DRĂGHICI Florin



E-mail

florin.draghici@upb.ro

Naționalitate

Română

Domeniul ocupațional

Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București (UNSTPB), Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației (ETTI), Departamentul Dispozitive, Circuite și Arhitecturi Electronice (DCAE), **Profesor universitar**

Experiența profesională

Perioada

1998 – prezent, Facultatea ETTI din UNSTPB, Departamentul DCAE

Funcții didactice ocupate prin concurs:

Din 2022 – Profesor universitar

2014 - 2022 – Conferențiar universitar

2004 – 2014 – Șef de lucrări

2001 - 2004 – Asistent universitar

1998 - 2001 – Preparator universitar

Activități și responsabilități
principale

- Titular de curs la disciplinele de electronică fundamentală "*Dispozitive electronice*" și "*Circuite Electronice Fundamentale*" de la ciclul de licență al Facultății ETTI
- Titular de curs la disciplina "*Controlul electronic al motoarelor cu ardere internă*", de la ciclul de Master al Facultății de Inginerie Mecanică și Mecatronică (FIMM)
- Conducere "*Proiect 1 - Dispozitive și circuite electronice*", ETTI, UNSTPB, *responsabil de disciplină*
- Conducere laborator și seminar la disciplinele:
 - "*Dispozitive Electronice*", ETTI, UNSTPB
 - "*Circuite Electronice*", ETTI, UNSTPB
 - "*Controlul electronic al motoarelor cu ardere internă*", Master - FIMM, UNSTPB
- Conducere lucrări de diplomă și disertații
- Membru al comisiei pentru examenul de diplomă la Secția Microelectronică, Optoelectronică și Nanotehnologii (MON), ETTI, UNSTPB
- Membru în comisia de admitere master
- Membru în comisii de îndrumare doctoranzi și de susținere publică a tezelor de doctorat
- Responsabil/membru în echipe de cercetare a proiectelor derulate în UNSTPB
- Responsabil realizare documentație pentru audit ARACIS în cadrul Departamentului DCAE din 2014
- Membru în Biroul DCAE, ETTI din 2012
- Coordonarea activității tehnice din Laboratorul de Dispozitive și Circuite Electronice – Studii Avansate (DCE-SA) (<https://eeris.eu/ERIF-2000-000M-2131>)
- Membru în comitetul de organizare al concursului profesional național "*Tudor Tănăsescu*".

Numele și adresa angajatorului

UNSTPB, Splaiul Independenței 313, București 6, România.

Tipul activității sau sectorul de activitate	Educație, cercetare
Perioada	2009 – 2023
Funcția sau postul ocupat	Colaborare, inginer proiectare
Activități și responsabilități principale	Proiectare de circuite integrate de joasă tensiune și mică putere în tehnologii CMOS
Numele și adresa angajatorului	ON Semiconductor - filiala România, Bd. Iuliu Maniu 6Q, București, 061103
Tipul activității sau sectorul de activitate	Proiectare circuite integrate
Perioada	2006 – 2009
Funcția sau postul ocupat	Colaborare, inginer proiectare
Activități și responsabilități principale	Proiectare de circuite integrate de joasă tensiune și mică putere în tehnologii CMOS
Numele și adresa angajatorului	Catalyst Semiconductor - filiala România, Str. Thomas Masaryk, Nr. 19
Tipul activității sau sectorul de activitate	Proiectare circuite integrate în tehnologii CMOS
Perioada	2002 – 2005
Funcția sau postul ocupat	Colaborare, inginer service/proiectare
Activități și responsabilități principale	Activitate de instalare/punere în funcțiune, service pentru aparatură analitică științifică/industrială (High Tech): gaz-cromatografe, absorbții atomice, spectrometre de masă, aparatură/senzori pentru analiza parametrilor mediului, aparatură pentru analiza imisiilor și emisiilor în mediu, aparatură pentru electrochimie, aparatură nucleară (dozimetrie RX, spectrometrie X, etc.), RX-medical. Unul din proiecte s-a concretizat cu brevetul cu nr. 122980/28.05.2010.
Numele și adresa angajatorului	Mecro System s.r.l, B-dul Timișoara 100P, București, sector 6, România
Tipul activității sau sectorul de activitate	Service/instalare aparatură științifică/industrială, proiectare circuite de interfațare
Educație și formare	
Perioada	2010 – 2013
Calificarea / diploma obținută	Studii posdoctorale, Proiect POSDRU/89/1.5/S/63700 Proiect cu tema: „Senzori de temperatură bazați pe diode Schottky realizate pe Carbură de Siliciu (SiC) pentru aplicații în industria cimentului”
Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite	Proiect multidisciplinar ce a solicitat cunoștințe avansate și deopotrivă experiență în inginerie electronică, fizica semiconductorilor, dispozitive semiconductoare, circuite electronice, știința materialelor, măsurări electrice și electronice. Stagiu de cercetare postdoctoral la Centro Nacional de Microelectronica (CNM) Barcelona, Spania (2012). Tehnici și circuite de măsurare timpilor de revenire inversă și a sarcinii stocate în comutarea la înaltă tensiune (până la 4kV) la diode ultrarapide pe SiC. Testare și caracterizare senzori de temperatură realizați pe SiC.
Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare	Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie - IMT București
Perioada	1998-2004
Calificarea / diploma obținută	Doctor în Inginerie Electronică și Telecomunicații/ Diploma de Doctor

	Titlul tezei: “<i>Caracterizarea și testarea dispozitivelor de putere și temperaturi înalte pe carbură de siliciu</i>”
Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite	Caracterizarea și testarea dispozitivelor electronice de mică și mare putere și temperaturi înalte realizate pe materiale de bandă largă (carbură de siliciu - SiC) Studiul și caracterizarea senzorilor fotoelectrici pe SiC Proiectarea, simularea și realizarea de circuite analogice Concept/realizare de module pentru caracterizarea I/V, temperatură, comutație, etc. a dispozitivelor electronice realizate pe materiale de bandă largă Proiectarea și realizarea de sisteme de testare la temperaturi înalte a dispozitivelor realizate pe SiC
Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare	Universitatea POLITEHNICA din București, Facultatea ETTI
Perioada	2003
Calificarea / diploma obținută	Specializare pentru operare, instalare și service pentru generatoare de înaltă frecvență pentru tuburi de raze X / Atestat
Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite	Operare, instalare și service pentru generatoare de înaltă frecvență pentru tuburi de raze X
Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare	SEDECAL, Algete-Madrid, Spania
Perioada	2003
Calificarea / diploma obținută	Securitate radiologică în activități de utilizare/MRIV instalații cu generatoare X, nivel 2 (aviz CNCAN nr.16/2003)
Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite	MRIVX, operare cu aparatură nucleară, raze X.
Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare	Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară „Horia Hulubei” – IFIN-HH
Perioada	2000, 2001
Calificarea / diploma obținută	
Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite	Două stagii de pregătire a doctoratului de câte două luni pe an la CNM Barcelona, Spania. Studii pe problema măsurării timpilor de revenire inversă la diode pe SiC, a caracterizării la temperaturi înalte a dispozitivelor semiconductoare realizate pe SiC și a tehnicilor de termostatare la temperaturi înalte. Realizare modul de măsurare a sarcinii stocate și a timpilor de revenire inversă la diode hiperrapide (comutare la joasă tensiune, sub 200V). Realizare aparat finit pentru caracterizarea la temperaturi înalte la nivel de plachetă.
Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare	CNM Barcelona, Spania.
Perioada	1998-1999
Calificarea / diploma obținută	Microsisteme / Dipomă de Studii aprofundate
Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite	Studii aprofundate, profilul Electronic, Specializarea Microsisteme. Studii referitoare la structuri, circuite si tehnologii microelectronice

Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare	Universitatea POLITEHNICA din București
Perioada	1993-1998
Calificarea / diploma obținută	Inginer – specializarea Microelectronică, Diploma de licență Studii universitare de pedagogie - “Pedagogie și psihologie educațională”, Certificat de absolvire care conferă titularului dreptul de a profesa în calitate de cadru didactic
Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite	Facultatea de Electronică și Telecomunicații, specializarea Microelectronică; Inginer electronist
Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare	Universitatea POLITEHNICA din București
Perioada	1990-1993
Calificarea / diploma obținută	Depanator de aparatură electronică, audio-video, radio și televizoare, diploma obținută conferă drept de liberă practică
Disciplinele principale studiate / competențe profesionale dobândite	Școală postliceală de specialitate
Numele și tipul instituției de învățământ / furnizorului de formare	Grup școlar cooperatist Constanța
Activitatea de cercetare, proiecte de cercetare-dezvoltare	
Director/responsabil de proiect	
Perioada	2017– 2021
Proiectul	Parteneriate naționale – proiecte complexe, PN-III-P1-1.2-PCCDI2017-0419, "Senzori și sisteme integrate electronice și fotonice pentru securitatea persoanelor și a infrastructurilor (SENSIS)", Responsabil din partea UPB pe proiectul component P2: "Senzori de hidrocarburi pe SiC pentru securitatea în exploatare în medii industriale ostile (SiC-SENS)". https://sensis-ict.ro/senzori-de-hidrocarburi-pe-sic-pentru-masurarea-concentrațiilor-de-hidrogen-si-hidrocarburi/ Bugetul total al proiectului complex a fost de 5287500lei. Proiectul component P2 a fost bugetat cu 1142000lei din care, bugetul UPB a fost de 430000lei, din bugetul de stat. Lucrări publicate: 1. R. Pascu, M. Danila, P. Varasteanu, M. Kusko, G. Pristavu, G. Brezeanu, F. Draghici , "Improved Ti/Pt/Au - n-Type Si Contacts by Post-Metallization Annealing in Nitrogen Atmosphere", 2018 International Semiconductor Conference (CAS), Sinaia, Romania, 2018, pp. 307-310, IEEE, DOI: 10.1109/SMICND.2018.8539839, WOS:000514386700064 2. R. Pascu, C. Romanitan, M. Kusko, P. Varasteanu, G. Pristavu, F. Draghici , G. Brezeanu, "Using polyoxides as an alternative technological approach to obtain a high quality MOS oxide on SiC", prezentat la European Conference on Silicon Carbide and Related Materials (ECSCRM 2018), Birmingham, UK, 2018. 3. G. Pristavu, G. Brezeanu, R. Pascu, M. Badila, F. Draghici , I. Rusu, "Series Resistance Effect on Inhomogeneous SiC-Schottky Diode Forward Characteristics - An Ideal Interpretation", prezentat la European Conference on Silicon Carbide and Related Materials (ECSCRM 2018), Birmingham, UK, 2018.

4. G. Pristavu, G. Brezeanu, R. Pascu, **F. Drăghici**, M. Badila, "*Characterization of non-uniform Ni-4H/SiC Schottky diodes for improved responsivity in high-temperature sensing*", prezentat la E-MRS Fall Meeting and Exhibit, Varsovia, Polonia, 2018.
5. R. Pascu, C. Romanitan, P. Varasteanu, G. Brezeanu, G. Pristavu, V. Craciun, "*Microstructural and electrical investigations of the interface layer between SiO₂/SiC: polyoxides vs. thermally grown oxides*", prezentat la E-MRS Fall Meeting and Exhibit, Varsovia, Polonia, 2018.
6. G. Pristavu, G. Brezeanu, R. Pascu, **F. Drăghici**, M. Bădilă, "*Characterization of non-uniform Ni/4H-SiC Schottky diodes for improved responsivity in high-temperature sensing*", Materials Science in Semiconductor Processing, Vol. 94, 2019, Pages 64-69, ISSN 1369-8001, <https://doi.org/10.1016/j.mssp.2019.01.018>, WOS:000458507800009, Q1.
7. **F. Drăghici**, G. Brezeanu, G. Pristavu, R. Pascu, M. Badila, A. Pribeanu, E. Ceuca, "*400°C Sensor Based on Ni/4H-SiC Schottky Diode for Reliable Temperature Monitoring in Industrial Environments*". Sensors 2019, 19, 2384, publicare online <https://doi.org/10.3390/s19102384>, pp. 1-16, WOS:000471014500171, Q1.
8. A. Enache, **F. Drăghici**, G. Pristavu, G. Brezeanu, "*Voltage Controlled Oscillator for Small-Signal Capacitance Sensing*", in Proceedings of the 2019 International Semiconductor Conference (CAS), Sinaia, Romania, 9-11 Oct. 2019, pp: 323-326, DOI: 10.1109/SMICND.2019.8923728, WOS:000514295300068
9. G. Brezeanu, G. Pristavu, **F. Drăghici**, R. Pascu, F. Della Corte, S. Rascuna, "*Enhanced Non-Uniformity Modeling of 4H-SiC Schottky Diode Characteristics Over Wide High Temperature and Forward Bias Ranges*", IEEE JOURNAL OF THE ELECTRON DEVICES SOCIETY, Volume: 8, Pages: 1339-1344, 2020, DOI: 10.1109/JEDS.2020.3032799, ISSN: 2168-6734, WOS:000589593200001, Q2.
10. A. Enache, **F. Drăghici**, F. Mitu, R. Pascu, G. Pristavu, M. Pantazica, G. Brezeanu, "*PLL-Based Readout Circuit for SiC-MOS Capacitor Hydrogen Sensors in Industrial Environments*", Sensors 2022, 22, 1462. <https://doi.org/10.3390/s22041462>, WOS:000769505800001, Q1.

2007-2010

Perioada
Proiectul

Parteneriate în domeniile prioritare, Programului 4, directia de cercetare 1.7.5, GIGASABAR, "*Rezonatori de tip SAW și FBAR dedicați aplicațiilor în comunicații pentru gama 2-6 GHz și în domeniul senzorilor, obținuți prin tehnici de microprelucrare și nanoprocesare a semiconductorilor de bandă largă GaN și AlN*", Responsabil din partea UPB. Bugetul total al proiectului a fost de 819016,6lei. Suma finanțată pentru P2- UPB, 31185lei, bugetul de stat, <http://www.imt.ro/gigasabar/>

Lucrări publicate:

1. G. Brezeanu, **F. Drăghici**, F. Craciunioiu, C. Boianceanu, F. Bernea, F. Udrea, D. Puscasu, I. Rusu, "*4H-SiC Schottky Diodes for Temperature Sensing Applications in Harsh Environments*", in Proc. of 8th European Conference on Silicon Carbide and Related Materials, 29 aug.-02 Sept, 2010, Oslo, Norvege, pp TP139.
2. **F. Drăghici**, I. Rusu, G. Brezeanu, B. Bucur, "*An Accurate Method For Measuring Very Low Frequency Biosignals*", in Proc. of the 32nd International Semiconductor Conference, 12-14 Oct. 2009, Sinaia, Romania, pp. 423-426.
3. A. Müller et. al, "*FBAR and SAW devices on GaN/Si operating in the GHz frequency range*", in Proc. of Smart System Integration Conf., Dresden, 22-23 March 2011, Digital proceedings paper 13.
4. R. Pascu, **F. Drăghici**, M. Bădila, F. Crăciunioiu, G. Brezeanu, A. Dinescu, I. Rusu, "*High Temperature Sensor Based on SiC Schottky Diodes with Undoped Oxide Ramp Termination*", in Proc. of the 34th International Semiconductor Conference, 17-19 Oct. 2011, Sinaia, Romania, vol. 2, pp. 379-382, ISBN: 978-1-61284-173-1, IEEE Catalog Number CFP11CAS-PRT.

Membru în echipa de cercetare**Proiecte internaționale**

1. Bilateral cooperation with Foundation for Research & Technology-Hellas (FORTH), Heraklion, Crete, Greece, "*Periphery isolation for 4H-SiC high frequency power p-i-n diodes with applications in wireless communications*", derulare: 2003-2005.
2. Microserv Project, "*High Temperature SiC Power Schottky Diode*", Politehnica University of Bucharest, Romania", 2000-2002.
3. Contract D107 cu Banca Mondială, "*Dispozitive circuite și microsisteme electronice*", 1999-2001.
4. INCO-Copernicus – Project: 960211/1996, "*Lely SiC High Temperature Power Diode Fabrication (PODILESCA)*", (finanțat de U.E.), 1996 – 1998.

Proiecte naționale

1. 673PED din 21/06/2022, "*Senzori rezistivi bazati pe materiale nanocarbonice pentru aplicatii IoT - de la sinteza de material, la electronica de readout*", membru în echipa de cercetare, 2022-2024.
2. 275-PED/2020, „*Senzori PTAT de înaltă temperatură cu diode Schottky pe SiC pentru monitorizare și securitate în medii industriale ostile*”, derulare 2020-2022.
3. PN-III-P2-2.1-PED-2019-4146/ PED 333/2020, "*Dispozitiv electrochimic modular pentru stocarea de sarcina*”, acronim MSTODE, 2020-2022.
4. Programul Operațional Capital Uman (POCU), 2014-2020, Axa Prioritară 6- Educație și competențe, Cod SMIS 125125, Nr. contract: 51675/09.07.2019, "*Dezvoltarea competențelor de antreprenoriat ale doctoranzilor și postdoctoranzilor – cheie a succesului în carieră (A-Succes)*”, Proiect cofinanțat din Fondul Social European (FSE), Expert calitate programe doctorale, 2019 – 2021.
5. Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Cod MySmis: 105976, „*NETIO – Ecosistem de cercetare, inovare și dezvoltare de produse și servicii TIC pentru o societate conectată la Internet of Things*”, Responsabil tehnic teme de cercetare, 2016-2020.
6. Proiect PN-III-P2-2.1-PED-2016-0503, contract Nr.180, PED/2017 „*Metodă rapidă de analiză bazată pe biosenzor enzimatic pentru determinarea aspartamului din alimente*” (ASPSSENS), UPB în parteneriat cu INCDSB, 2017-2019.
7. Parteneriat PN-II-PT-PCCA 2013-4-0297, contract Nr. 146/2016, "*Sistem multiparametric pentru monitorizarea fermentării vinului*", UPB în parteneriat cu INCDSB (INSB)-coordonator, 2014-2016.
8. Proiect PN-II-PCCA, 21/2-0479/PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-0487, "*Senzor inteligent de temperaturi ridicate cu diode pe carbură de siliciu (SiC) pentru aplicații industriale în medii ostile, SiC-SET*", 2012-2016.
9. Proiect PN-II-PCCA Nr. 204/2012, "*Detector de gaze inflamabile și toxice bazat pe matrice de senzori MOS pe carbură de siliciu*", SiC-GAS, 2012-2016.
10. Proiect postdoctoral, POSDRU/89/1.5/S/63700, cu tema individuală "*Senzori de temperatură bazați pe diode Schottky realizate pe Carbură de Siliciu (SiC) pentru aplicații în industria cimentului*", finanțator - Autoritatea de Management al Programului Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane AM POSDRU, Responsabil de proiect/Postdoctorand, 2010 -2013.
11. Parteneriat PN2, DIASENZOR – D-11062, "*Diode senzor pe Diamant și SiC pentru aplicații speciale în industria cimentului*", derulare 2007-2010.
12. Grant/ platforma CNCSIS - Platforma Ingineria Integrată a Autovehiculelor – AUTOINTEGRING, 2006-2008.
13. Grant CNCSIS, "*Fotodiode de mare eficiență pe carbură de siliciu pentru detecția radiațiilor ultraviolete*", 2004-2006.
14. Contract RELANSIN - 375/24/12/1999, "*Dispozitive Schottky pe carbură de siliciu pentru aplicații speciale de putere și temperatură*", 1999 – 2002.

15. Grant ANSTI – 5076 – A63 (15.02.07), “Caracterizarea și testarea dispozitivelor pe SiC pentru aplicații speciale de putere și temperatură”, 2002.
16. Grant ANSTI – 5076 – A25 (15.01.12), “Caracterizarea și testarea dispozitivelor pe SiC pentru aplicații speciale de putere și temperatură”, 2001.
17. Grant ANSTI – 5076 – B77 (15.99.16), “Caracterizarea și testarea dispozitivelor pe SiC”, 1999.
18. Grant ANSTI – 3042 – A16 (15.97.14), “Fizica interfeței SiO₂ – SiC cu aplicații la tranzistoare MOS și diode Schottky”, 1997.
19. Grant MEN – B961 (15.97.11), “Modelarea procesului de comutație a dispozitivelor semiconductoare”, 1997.

Publicații

- Autor/coautor a peste 70 articole de specialitate în reviste/ proceedings-uri din domeniul electronicii/microelectronicii. 61 dintre acestea sunt indexate WOS, 10 fiind în categoriile Q1 sau Q2.
- Autor la o carte și coautor la o monografie
- Coautor la două culegeri de probleme de dispozitive și circuite electronice
- Coautor la două îndrumare de laborator de dispozitive și circuite electronice

Premii sau alte elemente de recunoaștere a contribuțiilor științifice

Premii, distincții

- Coautor la patru articole premiate “Best Paper Award” la International Semiconductor Conference (CAS), Sinaia, România în anii 1998, 2002, 2008 și 2009
- Un brevet OSIM ca prim autor, obținut în anul 2010
- Un certificat de inovator (coautor), 1989

Alte elemente de recunoaștere a contribuțiilor științifice

- Obținerea Atestatului de abilitare – conducere de doctorat, mai, 2022
- Peste 150 de citări în lucrări de specialitate din care 125 sunt în articole indexate ISI
- Membru al Paper Review Board International Semiconductor Conference - CAS, Sinaia, Romania, din 2011
- Evaluator lucrări pentru “The 9th European Conference on Silicon Carbide and Related Materials (ECSCRM 2012)”
- Chairman la International Semiconductor Conference - CAS, Sinaia, Romania, din 2013
- Membru in International Steering Committee, SIITME, 2016-2023
- Associate Editor, ROMJIST, din 2017
- Recenzor SENSORS, 2019
- Recenzor Journal of Applied Physics, 2019
- Recenzor Solid-State Electronics, 2024
- Recenzor la revista Buletin Științific al Universității Politehnica din București, din 2019

Aptitudini și competențe personale

Limba maternă

Limba română

Limbi străine cunoscute

Autoevaluare

Nivel european (*)

Limba engleză

Limba franceză

Înțelegere		Vorbire		Scriere	
Ascultare	Citire	Participare la conversație	Discurs oral	Exprimare scrisă	
B2	B2	B2	B1	B2	
A2	B1	A2	A2	A2	

(*) [Nivelul Cadrului European Comun de Referință Pentru Limbi Străine](#)

Competențe și abilități sociale	Lucrul în echipă, adaptabilitate, aptitudini de comunicare, responsabilitate, voluntariat.
Competențe și aptitudini organizatorice	Competențe organizatorice dobândite prin activitățile realizate în cadrul proiectelor de cercetare naționale și internaționale Coordonatorul disciplinei P1-Dispozitive si circuite electronice (P1-DCE) pentru intregul an 3 al ciclului de licență al Facultății ETTI din UNSTPB Coordonare proiecte de diplomă/semestru Membru în echipa de organizare a concursului profesional “Tudor Tănăsescu”. Membru in biroul Departamentului DCAE, ETTI, UPB, din 2012 Realizarea documentației pentru re acreditarea ARACIS a Programului de studii Microelectronică, Optoelectronică și Nanotehnologii (MON), audit re acreditare în anii 2015 și 2021
Competențe și aptitudini tehnice	Software CAD (Cadence, Mentor, HSpice, Orcad, TINA-Spice, ExpressPCB, LTSpice) Specializare operare Pyxis – IC Design Flow, Mentor Graphics, 2013, certificat. Proiectare și realizare de circuite electronice analogice Dezvoltare de sisteme de testare de dispozitive și circuite electronice Peste 30 ani de experiență în service de aparatură electronică de larg consum și profesională Service mecanică, instalații de gaze și lichide Service PC
Competențe și aptitudini de utilizare a calculatorului	Sisteme de operare: MS-DOS, Windows, Linux (nivel mediu) Utilizare pachet MS-Office
Competențe și aptitudini artistice	Fotografie
Permis de conducere	Categoria B
Informații suplimentare	Referințele pot fi furnizate la cerere.

16.02. 2024

Prof. Dr. Ing. Florin Drăghici

A. Primele 100 de lucrări din pagina Google Scholar, în ordinea descrescătoare a citărilor.

- A1. G. Brezeanu, G. Pristavu, F. Draghici, M. Badila, R. Pascu, "Characterization Technique for Inhomogeneous 4H-SiC Schottky Contacts: A Practical Model for High Temperature Behavior", *Journal of Applied Physics*, Vol. 122, Article Number: 084501, 2017, <https://doi.org/10.1063/1.4999296>, WOS:000409117200029, ISSN: 0021-8979, EISSN: 1089-7550, Q2 în Domeniul Physics, Applied, FI=2,546 anul 2022, 39 de citări
- A2. G. Brezeanu, F. Draghici, F. Craciunoiu, C. Boianeanu, F. Bernea, F. Udrea, D. Puscasu, I. Rusu, "4H-SiC Schottky Diodes for Temperature Sensing Applications in Harsh Environments", *Materials Science Forum*, Vols. 679-680, 2011, pp. 575-578, ISBN: 978-3-03785-079-4, <https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.679-680.575>, WOS:000291673500138, Q4 în Domeniul Materials Science, Multidisciplinary, FI=0,399 la data publicării, 35 de citări
- A3. G. Pristavu, G. Brezeanu, R. Pascu, F. Drăghici, M. Bădilă, "Characterization of non-uniform Ni/4H-SiC Schottky diodes for improved responsivity in high-temperature sensing", *Materials Science in Semiconductor Processing*, Volume 94, 2019, Pages 64-69, ISSN 1369-8001, <https://doi.org/10.1016/j.mssp.2019.01.018>, WOS:000458507800009, Q1 în Domeniul Engineering, Electrical & Electronic, FI=3,927 în 2022, 31 de citări
- A4. F. Draghici, G. Brezeanu, G. Pristavu, R. Pascu, M. Badila, A. Pribeanu, E. Ceuca, "400°C sensor based on Ni/4H-SiC Schottky diode for reliable temperature monitoring in industrial environments", *Sensors*, 2019, 19, 2384, [HTTPS://DOI.ORG/10.3390/S19102384](https://doi.org/10.3390/S19102384), WOS:000471014500171, Q1 în Domeniul Instruments & Instrumentation, FI=3,576 în 2022, 22 de citări
- A5. Pavel, R. Chiriac, A. Birtas, F. Draghici, M. Dinca, "On the improvement by laser ignition of the performances of a passenger car gasoline engine", *Optics Express*, Vol. 27, No. 8, 2019, <https://doi.org/10.1364/OE.27.00A385>, WOS:000464614400013, Q1 în Domeniul Optics, FI=3,894 în 2022, 20 de citări.
- A6. G. Brezeanu, M. Badila, F. Draghici, R. Pascu, G. Pristavu, F. Craciunoiu, I. Rusu, "High temperature sensors based on silicon carbide (SiC) devices", in *Proc. of the 38th International Semiconductor Conference*, 12-14 Oct. 2015, Sinaia, Romania, pp. 3-10, ISBN: 978-1-4799-8862-4, ISSN: 1545-827X, DOI: [10.1109/SMICND.2015.7355147](https://doi.org/10.1109/SMICND.2015.7355147), WOS:000380566400001, 19 de citări
- A7. R. Pascu, G. Pristavu, G. Brezeanu, F. Draghici, P. Godignon, C. Romanitan, M. Serbanescu, A. Tulbure, "60-700K CTAT and PTAT Temperature Sensors with 4H-SiC Schottky Diodes", *Sensors*, 2021, 21(3), 942; pp. 1-15, publicare online, eISSN: 1424-8220, <https://doi.org/10.3390/s21030942>, WOS:000615521900001, Q1 în Domeniul Instruments & Instrumentation, FI=3,576 în 2022, 14 de citări
- A8. G. Brezeanu, F. Draghici, M. Badila, F. Craciunoiu, G. Pristavu, R. Pascu, F. Bernea, "Two Packaging Solutions for High Temperature SiC Diode Sensors", *Materials Science Forum*, cu titlul Silicon Carbide and Related Materials 2013 PTS 1 and 2, Vols. 778-780, 2014, pp. 1063-1066, ISSN: 0255-5476, <https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.778-780.1063>, WOS:000336634100253, Q4 în Domeniul Materials Science, Multidisciplinary, FI=0,399 in 2022, 13 de citări
- A9. G. Pristavu, G. Brezeanu, M. Badila, F. Draghici, R. Pascu, F. Craciunoiu, I. Rusu, A. Pribeanu, "Barrier Stability of Pt/4H-SiC Schottky Diodes Used for High Temperature Sensing", *Materials Science Forum*, Vol. 897, cu titlul - Silicon Carbide and Related Materials 2016, pp. 606-609, May 2017, ISSN: 02555476, ISBN: 978-303571043-4, <https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.897.606>, 11 citări
- A10. R. Pascu, F. Draghici, M. Badila, F. Craciunoiu, G. Brezeanu, A. Dinescu, I. Rusu, "High Temperature Sensor Based on SiC Schottky Diodes with Undoped Oxide Ramp Termination", in *Proc. of the 34th IEEE International Semiconductor Conference*, 17-19 Oct. 2011, Sinaia, Romania, Vol. 2, pp. 379-382, ISSN: 1545-827X, ISBN: 978-1-61284-171-7, DOI: [10.1109/SMICND.2011.6095823](https://doi.org/10.1109/SMICND.2011.6095823), WOS:000320322000086, 11 citări
- A11. F. Draghici, M. Badila, G. Brezeanu, I. Rusu, F. Craciunoiu, I. Enache, "An Industrial Temperature Probe Based on SiC Diodes", in *Proc. of the 33rd International Semiconductor Conference*, 11-13 Oct. 2010, Sinaia, Romania, vol. 2, pp. 409-412, ISBN: 978-1-4244-5971-6, ISSN: 1545-827X, DOI: [10.1109/SMICND.2010.5650596](https://doi.org/10.1109/SMICND.2010.5650596), WOS:000371396100084, 11 citări
- A12. F. Draghici, X. Jorda, G. Brezeanu, M. Badila, J. Millan, P. Godignon, "A System for Measure Reverse Recovery Time and Stored Charge at Ultrafast Power Diodes", in *Proc. of the 24th IEEE International Semiconductor Conference*, 9-13 Oct., 2001, Sinaia, Romania, pp. 473-476, ISBN: 0-7803-6666-2, DOI: [10.1109/SMICND.2001.967508](https://doi.org/10.1109/SMICND.2001.967508), WOS:000175459600100, 11 citări
- A13. R. Pascu, G. Pristavu, M. Badila, G. Brezeanu, F. Draghici, F. Craciunoiu, "Temperature Behavior of 4H-SiC MOS Capacitor Used as a Gas Sensor", in *Proc. of the 37th International Semiconductor Conference (CAS)*, 13-15 Oct. 2014, Sinaia, Romania, pp. 185-188, ISBN: 978-1-4799-3916-9, ISSN: 1545-827X, DOI: [10.1109/SMICND.2014.6966430](https://doi.org/10.1109/SMICND.2014.6966430), WOS:000380488300036, 10 citări

- A14. G. Brezeanu, G. Pristavu, F. Draghici, R. Pascu, F. Della Corte, S. Rascuna, "Enhanced Non-Uniformity Modeling of 4H-SiC Schottky Diode Characteristics Over Wide High Temperature and Forward Bias Ranges", *IEEE Journal of the Electron Devices Society*, Volume: 8, Pages: 1339-1344, 2020, DOI: [10.1109/JEDS.2020.3032799](https://doi.org/10.1109/JEDS.2020.3032799), ISSN: 2168-6734, WOS:000589593200001, **Q2** în Domeniul Engineering, Electrical & Electronic, FI=2,555 în 2022, 9 citări
- A15. R. Pascu, F. Craciunoiu, M. Kusko, F. Draghici, A. Dinescu, M. Danila, "The Effect of the Post-Metallization Annealing of Ni/n-type 4H-SiC Schottky Contact", in *Proc. of the 35th IEEE International Semiconductor Conference*, 15-17 Oct. 2012, Sinaia, Romania, vol. 2, IEEE Catalog Number: CFP12CAS-PRT, ISBN: 978-1-4673-0736-9, ISSN: 1545-827X, pp. 457-460, DOI: [10.1109/SMICND.2012.6400732](https://doi.org/10.1109/SMICND.2012.6400732), WOS:000314223700095, 9 citări
- A16. A. Birtas, N. Boicea, G. Croitoru, M. Dinca, N. Pavel, F. Draghici, R. Chiriac, "On the possibility to improve petrol engine operation by laser ignition", *Energy Procedia*, Vol. 157, pp. 1022-1028, Elsevier, 2019, ISSN: 1876-6102, <https://doi.org/10.1016/j.egypro.2018.11.269>, WOS:000470998600112, 6 citări
- A17. F. Draghici, M. Badila, G. Brezeanu, G. Pristavu, I. Rusu, F. Craciunoiu, R. Pascu, "4H-SiC Schottky Contact Improvement for Temperature Sensor Applications", in *Proc. of the 36th International Semiconductor Conference (CAS)*, 14-16 oct. 2013, Sinaia, Romania, Vol. 2, ISBN:978-1-4673-5672-5; 978-1-4673-5670-1, ISSN: 1545-827X, DOI: [10.1109/SMICND.2013.6688645](https://doi.org/10.1109/SMICND.2013.6688645), WOS:000330180800033, 6 citări
- A18. L. Teodorescu, F. Draghici, G. Brezeanu, I. Rusu, "High Temperature Characterization System for Silicon Carbide Devices", in *Proc. of the 35th IEEE International Semiconductor Conference (CAS)*, Oct. 15-17 2012, Sinaia, Romania, Vol. 2, IEEE Catalog Number: CFP12CAS-PRT, ISBN: 978-1-4673-0736-9, ISSN: 1545-827X, pp. 449-452, DOI: [10.1109/SMICND.2012.6400734](https://doi.org/10.1109/SMICND.2012.6400734), WOS:000314223700093, 6 citări
- A19. R. Pascu, G. Pristavu, G. Brezeanu, F. Draghici, M. Badila, I. Rusu, F. Craciunoiu, "Electrical Characterization of Ni-Silicide Schottky Contacts on SiC for High Performance Temperature Sensor", *Materials Science Forum*, Vols. 821-823, pp. 436-439, 2015, [Scopus, INSPEC], <https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.821-823.436>, 5 citări.
- A20. G. Brezeanu, F. Draghici, M. Badila, I. Rusu, F. Bernea, P. Godignon, "A Fully Electrically Isolated Package for High Temperature SiC Sensors", *Materials Science Forum*, with title Silicon Carbide and Related Materials 2011, Vols. 717-720, 2012, 925-928, ISBN: 978-3-03785-419-8, <https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.717-720.925>, WOS:000309431000220, **Q4** în Domeniul Materials Science, Multidisciplinary, FI=0,399 în 2022, 5 citări
- A21. G. Brezeanu, G. Dilimot, F. Mitu, F. Drăghici, "Probleme de Dispozitive și Circuite Electronice", *Editura IT GRUP*, București, ediția a III-a, 2006, ISBN 973-85715-2-9, 5 citări
- A22. A. Enache, F. Draghici, F. Mitu, R. Pascu, G. Pristavu, M. Pantazica, G. Brezeanu, "PLL-Based Readout Circuit for SiC-MOS Capacitor Hydrogen Sensors in Industrial Environments", *Sensors* 2022, 22, 1462. <https://doi.org/10.3390/s22041462>, WOS:000769505800001, **Q1** în Domeniul Instruments & Instrumentation, FI=3,576 în 2022, 4 citări
- A23. M. Boncu, C. Botezatu, F. Draghici, "A precise method for compensating bandgap references over temperature", in *Proceedings of the 2020 International Semiconductor Conference (CAS)*, 7-9 Oct. 2020, Sinaia, Romania, pp. 245-248, eISBN:978-1-7281-1073-8, Print on Demand (PoD) ISBN:978-1-7281-1074-5, DOI: [10.1109/CAS50358.2020.9268045](https://doi.org/10.1109/CAS50358.2020.9268045), WOS:000637264600055, 4 citări
- A24. R.V. Petrica, M.D. Dobre, P. Coll, F. Draghici, G. Brezeanu, "Comparison of Level Shifter Architectures: Application to I/O Cell", in *Proc. of the 2018 International Semiconductor Conference (CAS)*, Sinaia, Romania, pp. 209-212, 2018, IEEE., DOI: [10.1109/SMICND.2018.8539796](https://doi.org/10.1109/SMICND.2018.8539796), WOS:000514386700041, 4 citări
- A25. A. Enache, I. Rusu, B. Bucur, F. Drăghici, G. Pristavu, M.P. Bucur, F. Enache, G. Brezeanu, "Experimental Characterization of a High Accuracy Amperometric Sense and Control Circuit for Three-Electrode Biosensors", in *Proc. of the 40th International Semiconductor Conference*, 11-14 Oct. 2017, Sinaia, Romania, pp.179-182, ISSN: 1545-827X, DOI: [10.1109/SMICND.2017.8101193](https://doi.org/10.1109/SMICND.2017.8101193), WOS:000425844500037, 4 citări
- A26. C. Ionescu, F. Drăghici, D. Bonfert, "A SPICE model for electroluminescent foils", in *Proc. of the 38th International Spring Seminar on Electronics Technology (ISSE)*, 6-10 May 2015, Eger, Hungary, pp: 526 - 531, ISSN: 2161-2528, DOI: [10.1109/ISSE.2015.7248057](https://doi.org/10.1109/ISSE.2015.7248057), WOS:000374113000105, 4 citări
- A27. F. Draghici, G. Brezeanu, I. Rusu, F. Bernea, P. Godignon, "High Temperature SiC Sensor With an Isolated Package", *Materials Science Forum*, 2013, with title Silicon Carbide and Related Materials 2012, vols. 740-742, ISBN: 978-3-03785-419-8, IDS: BFG56, <https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.740-742.1002>, WOS:000319785500239, **Q4** în Domeniul Materials Science, Multidisciplinary, FI=0,399 la data publicării, 4 citări
- A28. G. Brezeanu, F. Drăghici, "Circuite Electronice Fundamentale", *Editura Niculescu*, București, 2013, ISBN: 978-973-748-745-2, 4 citări
- A29. A. Sevcenco, G. Brezeanu, M. Badila, F. Draghici, I. Rusu, A. Visoreanu, "Experimental Validation of a Simple Analytical Model for the Electrical Behavior of Nanoscale MOSFETs", in *Proc. of the 30th IEEE International Semiconductor Conference*, 15-17 Oct. 2007, Sinaia, Romania, pp. 551-554, ISBN: 978-1-4244-0847-4, DOI: [10.1109/SMICND.2007.4519783](https://doi.org/10.1109/SMICND.2007.4519783), WOS:000255865200120, 4 citări
- A30. G. Brezeanu, M. Badila, M. Brezeanu, F. Udrea, C. Boianceanu, I. Enache, F. Draghici, A. Visoreanu, "Breakdown performances improvements of SiC diodes using high-k dielectrics", in *Proc. of the 28th IEEE International Semiconductor Conference*, 2-4 Oct., 2005, Sinaia, Romania, pp. 357-360, ISBN: 0-7803-9214-0, DOI: [10.1109/SMICND.2005.1558799](https://doi.org/10.1109/SMICND.2005.1558799), WOS:000237180300078, 4 citări
- A31. M. Badila, G. Brezeanu, V. Banu, P. Godignon, J. Millan, X. Jorda, F. Draghici, "SiC power Schottky diodes industrial development", in *Proc. of the 24th IEEE International Semiconductor Conference*, 9-13 Oct., 2001, Sinaia, Romania, pp. 337 - 340, ISBN: 0-7803-6666-2, DOI: [10.1109/SMICND.2001.967478](https://doi.org/10.1109/SMICND.2001.967478), WOS:000175459600070, 4 citări

- A32. G. Pristavu, G. Brezeanu, M. Badila, F. Draghici, R. Pascu, F. Craciunoiu, I. Rusu, A. Pribeanu, "High Temperature Behavior Prediction Techniques for Non-Uniform Ni/SiC Schottky Diodes", **Materials Science Forum**, Vol.924, pp. 967-970, 2018, Trans Tech Publication, <https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.924.967>, [Scopus, INSPEC], 3 citări
- A33. A. Birtas, N. Boicea, F. Draghici, R. Chiriac, G. Croitoru, M. Dinca T. Dascalu, N. Pavel, "On the assessment of performance and emissions characteristics of a SI engine provided with a laser ignition system", in (CAR2017) Book Series: IOP Conference Series-Materials Science and Engineering, Volume: 252, 2017, ISSN: 1757-8981, DOI: <http://dx.doi.org/10.1088/1757-898X/252/1/012071>, WOS:000419817200071, 3 citări
- A34. G. Pristavu, G. Brezeanu, M. Badila, F. Draghici, R. Pascu, F. Craciunoiu, "An Investigation of SiC Schottky Contact Barrier Inhomogeneity for Temperature Sensing Applications", **Materials Science Forum**, Vol. 858, pp. 577-581, 2016, Trans Tech Publication, <https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.858.577>, [Scopus, INSPEC], 3 citări
- A35. G. Pristavu, F. Draghici, G. Brezeanu, R. Pascu, F. Craciunoiu, "High Temperature SiC-Sensors", **IEEE 20th International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging, SIITME 2014 - Conference Proceedings**, pp. 329-332, Bucuresti, Romania, 23 - 26 October 2014, ISBN: 978-1-4799-6962-3, DOI: [10.1109/SIITME.2014.6967024](https://doi.org/10.1109/SIITME.2014.6967024), WOS:000358258300061, 3 citări
- A36. B. Ofrim, G. Brezeanu, F. Draghici, I. Rusu, "High Temperature Hydrogen Sensor based on Silicon Carbide (SiC) MOS Capacitor Structure", Proceedings with Abstracts (two pages) of the **International Conference on Silicon Carbide and Related Materials (ICSCRM2013)**, September 29 - October 4, 2013, Phoenix Seagaia Resort, Miyazaki, Japan, ISBN 978-4-86348-378-1, publicat ca abstract de 2 pagini in Proceedings-ul Conferintei ICSCRM2013 și selectionat pentru publicare in extenso in **Materials Science Forum 2014**, ISI, http://icscrm2013.org/index.php?plugin=attach&refer=program&openfile=ICSCRM2013_Technical_Program_1004Final.pdf, 3 citări
- A37. G. Brezeanu, A. Sevcenco, C. Boianceanu, I. Rusu, F. Draghici, „A Complete Analytical Submicron MOS Transistor Drain Model for Analog Applications”, in **Proc. of the 31th IEEE International Semiconductor Conference**, 13-15 Oct. 2008, Sinaia, Romania, pp. 309-312, ISBN: 978-1-4244-2004-9, DOI: [10.1109/SMICND.2008.4703411](https://doi.org/10.1109/SMICND.2008.4703411), WOS:000267590800063, 3 citări
- A38. G. Brezeanu, A. Visoreanu, M. Brezeanu, F. Udrea, G. A. J. Amaratunga, I. Enache, I. Rusu, F. Draghici, "OFF-State performance of Ideal Schottky Barrier Diodes (SBD) on Diamond and Silicon Carbide", in **Proc. of the 29th IEEE International Semiconductor Conference**, 27-29 Sept. 2006, Sinaia, Romania, pp. 319-322, ISBN: 1-4244-0109-7, DOI: [10.1109/SMICND.2006.284008](https://doi.org/10.1109/SMICND.2006.284008), WOS:000243090700066, 3 citări
- A39. M. Badila, G. Brezeanu, J. P. Chante, Marie-Laure Locatelli, J. Millan, P. Godignon, P. Lungu, F. Mitu, F. Draghici, F. J. Campos, A. Lebedev, V. Banu, G. Banoiu, "A Technique To Avoid Micropipe Effects on 6H-SiC Power Devices", in **Proc. of the 22nd International Semiconductor Conference**, 5-9 Oct., 1999, Sinaia, Romania, pp. 187 - 190, IEEE Catalog Number: 99TH8389, ISBN: 0-7803-513 9-8 Softbound Edition, 0-7803-5140-1 Microfiche Edition, IEEE - IEEEXplore, DOI: [10.1109/SMICND.1999.810459](https://doi.org/10.1109/SMICND.1999.810459), <http://ieeexplore.ieee.org>, 3 citări
- A40. G.-C. Ilie (Chiranu), C. Tudoran, O. Neagoe, F. Draghici, G. Brezeanu, "Nonvolatile Analog Switch for Low-Voltage Applications", **Electronics** 2021, 10(6), 736, <https://doi.org/10.3390/electronics10060736>, WOS:000634338200001, Q2 în Domeniul Engineering, Electrical & Electronic, FI=2,412 la data publicării, 2 citări
- A41. M. Gheorghe, P. Mugur Svasta, S. Gheorghe, C. Ionescu, F. Draghici, "Organic Electrical Passive Components Based on Polyaniline", 2020 **IEEE 8th Electronics System-Integration Technology Conference (ESTC)**, 15-18 Sept. 2020, Tønsberg, Vestfold, Norway, ISBN:978-1-7281-6293-5, ISBN:978-1-7281-6294-2, DOI: [10.1109/ESTC48849.2020.9229672](https://doi.org/10.1109/ESTC48849.2020.9229672), WOS: 000631824100013, 2 citări
- A42. A. Enache, F. Drăghici, G. Pristavu, G. Brezeanu, "Voltage Controlled Oscillator for Small-Signal Capacitance Sensing", in **Proceedings of the 2019 International Semiconductor Conference (CAS)**, Sinaia, Romania, 9-11 Oct. 2019, DOI: [10.1109/SMICND.2019.8923728](https://doi.org/10.1109/SMICND.2019.8923728), WOS:000514295300068, 2 citări
- A43. N. Pavel, R. Chiriac, A. Birtas, N. Boicea, F. Draghici, G. Croitoru, M. Dinca, "Lean-Mixture Operation of a Passenger Car Gasoline Engine Ignited by Passively Q-switched Nd: YAG/Cr4+: YAG Laser Spark Plugs", in **2019 Conference on Lasers and Electro-Optics Europe and European Quantum Electronics Conference**, OSA Technical Digest (Optical Society of America, 2019), paper cm_p_13., ISBN:978-1-7281-0469-0, DOI: [10.1109/CLEOE-EQEC.2019.8872741](https://doi.org/10.1109/CLEOE-EQEC.2019.8872741), WOS:000630002701062, 2 citări.
- A44. A. Enache, I. Rusu, F. Drăghici, Gh. Brezeanu, Gh. Pristavu, F. Enache, "Smart Sensor For Chemical Compounds Concentration", in **Proc. of the 39th International Semiconductor Conference**, 10-12 Oct. 2016, Sinaia, Romania, pp.201-204, ISBN: 9781509012077, ISSN: 1545827X, DOI: [10.1109/SMICND.2016.7783086](https://doi.org/10.1109/SMICND.2016.7783086), WOS:000391323300041.
- A45. N. Bădălan, P. Svasta, F. Drăghici, "Constant current versus pulse current for power supplies on high power LED", in **Proc. of the 21st International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging (SIITME)**, 2015 IEEE, 22-25 Oct. 2015, Brasov, Romania, pp. 263 - 266, DOI: [10.1109/SIITME.2015.7342337](https://doi.org/10.1109/SIITME.2015.7342337), WOS:000377765500049.
- A46. F. Draghici, B. Ofrim, G. Brezeanu, F. Mitu, F. Bernea, "High Temperature Automatic Characterization System For Semiconductor Devices", **Annals of the Academy of Romanian Scientists**, Vol.4, 2011, pp. 51-64, ISSN 2066-8562, http://www.aos.ro/site_mod/Publicatii/2011/AnaleINFOnr2pe2011.pdf, și Indexare Google Scholar, 2 citări
- A47. G. Brezeanu, F. Udrea, A. Mihaila, G. Amaratunga, J. Millan, P. Godignon, M. Badila, F. Draghici, C. Boianceanu, M. Brezeanu, "Numerical and Analytical Study of 6H-SiC Detectors with High UV Performance", in **Proc. of the**

- 25th IEEE International Semiconductor Conference, 2002, Sinaia, Romania, pp. 185-188, ISBN: 0-7803-7440-1, DOI: [10.1109/SMICND.2002.1105827](https://doi.org/10.1109/SMICND.2002.1105827), WOS:000181629400039, 2 citări
- A48. F. Draghici, F. Mitu, G. Brezeanu, M. Badila, C. Boianceanu, P. Agache, I. Enache, "Electrical and Optical Behavior of the SiC Photodetectors", in *Proc. of the 25th IEEE International Semiconductor Conference*, 8-12 Oct., 2002, Sinaia, Romania, pp.195 -198, ISBN: 0-7803-7440-1, DOI: [10.1109/SMICND.2002.1105829](https://doi.org/10.1109/SMICND.2002.1105829), WOS:000181629400041, 2 citări
- A49. F. Mitu, F. Draghici, G. Dilimot, C. Amitroaie, I. Vladan, "A Characterisation Technique for High Power/Temperature Devices Using HP4275/3437 Systems", in *Proc. of the 23rd IEEE International Semiconductor Conference*, 10-14 Oct. 2000, Sinaia, Romania, pp. 337-340, ISBN: 0-7803-5885-6, DOI: [10.1109/SMICND.2000.890251](https://doi.org/10.1109/SMICND.2000.890251), WOS:000168560900068, 2 citări
- A50. F. Draghici, F. Mitu, G. Dilimot, I. Enache, "Method to increase the thermal stability of the heating circuits", in *Proc. of the 21st International Semiconductor Conference*, 6-10 Oct. 1998, Sinaia, Romania, pp. 501-504, ISBN: 0-7803-4432-4, [10.1109/SMICND.1998.733795](https://doi.org/10.1109/SMICND.1998.733795), WOS:000078772400094, 2 citări
- A51. R. Pascu, G. Pristavu, D. T. Oneata, M. Stoian, C. Romanitan, M. Kusko, F. Draghici, G. Brezeanu, "Enhanced Method of Schottky Barrier Diodes Performance Assessment", *ROMJIST*, Volume 26, No. 2, 2023, pp. 181-192, DOI: [10.59277/ROMJIST.2023.2.05](https://doi.org/10.59277/ROMJIST.2023.2.05) (<https://www.romjist.ro/full-texts/paper741.pdf>), WOS:001014842500006, 1 citare
- A52. Moise, V., Draghici, F., Pristavu, G., Pascu, R., Oneata, D. T., & Brezeanu, G. (2022, October), "Intelligent Temperature Sensor with SiC Schottky Diode", *Proc. of the 2022 International Semiconductor Conference (CAS)*, pp. 123-126, IEEE. <https://doi.org/10.1109/CAS56377.2022.9934369>, 1 citare
- A53. Brezeanu, I. B., Botezatu, C., Drăghici, F., & Brezeanu, G. "Improved SPI Controlled, Low-Voltage, High Speed, Multi-Channel Switch", in *2022 14th International Conference on Electronics, Computers and Artificial Intelligence (ECAI)* (pp. 1-4). IEEE. DOI: [10.1109/ECAI54874.2022.9847444](https://doi.org/10.1109/ECAI54874.2022.9847444), 1 citare
- A54. N. Pavel, G. Croitoru, O.V. Grigore, N.T Vasile, T. Dascalu, A. Birtas, N. Boicea, M. Dinca, F. Draghici, and R. Chiriac. "Laser spark-plug development: from experimental device to successful engine ignition", in *Advances in 3OM: Opto-Mechatronics, Opto-Mechanics, and Optical Metrology*, vol. 12170, pp. 185-192. SPIE, 2022, <https://doi.org/10.1117/12.2620045>, WOS:000838058200021, 1 citare
- A55. A. Enache, I. Rusu, B. Bucur, F. Drăghici, G. Pristavu, M.P. Bucur, F. Enache, G. Brezeanu, "Experimental Characterization of a High Accuracy Amperometric Sense and Control Circuit for Three-Electrode Biosensors", in *Proc. of the 40th International Semiconductor Conference*, 11-14 Oct. 2017, Sinaia, Romania, pp.179-182, ISSN: 1545-827X, ISBN: 978-1-5090-3985-2, DOI: [10.1109/SMICND.2017.8101193](https://doi.org/10.1109/SMICND.2017.8101193), WOS:000425844500037, 1 citare
- A56. G. Pristavu, G. Brezeanu, R. Pascu, F. Draghici, M. Badila, I. Rusu, "Study on thermal sensitivity of highly inhomogeneous Ni/4H-SiC Schottky diode over a wide temperature range", in *Proc. of the 40th International Semiconductor Conference*, 11-14 Oct. 2017, Sinaia, Romania, pp. 255-256, ISSN: 1545-827X, ISBN: 978-1-5090-3985-2, DOI: [10.1109/SMICND.2017.8101216](https://doi.org/10.1109/SMICND.2017.8101216), WOS:000425844500056, 1 citare
- A57. G. Pristavu, G. Brezeanu, F. Draghici, "Two parameter extraction solutions for high temperature SiC Schottky diodes - Converging to reality", in *Proceedings of the IEEE 19th International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging (SIITME)*, Oct. 24-27, 2013, pp:181-184, ISBN:978-1-4799-1555-2, DOI: [10.1109/SIITME.2013.6743669](https://doi.org/10.1109/SIITME.2013.6743669), WOS:000347562900030, 1 citare
- A58. C. Boianceanu, G. Brezeanu, F. Udrea, G. Amaratunga, M. Brezeanu, A. Mihaila, F. Draghici, I. Enache, A. Visoreanu, "SiC Device Parameters Effects on the Electrical Behaviour of mCascode Switch", in *Proc. of the 27th International Semiconductor Conference*, 4-6 Oct., 2004, Sinaia, Romania, pp. 389-392, ISBN: 0-7803-8499-7, DOI: [10.1109/SMICND.2004.1403026](https://doi.org/10.1109/SMICND.2004.1403026), WOS:000228010700079, 1 citare
- A59. Pascu R, Pristavu G, Oneata D-T, Brezeanu G, Romanitan C, Djourellov N, Enache A, Draghici F, Ivan AM, Ceuca E, "Thorough Wide-Temperature-Range Analysis of Pt/SiC and Cr/SiC Schottky Contact Non-Uniformity". *Materials*, 2024, 17(2):400. <https://doi.org/10.3390/ma17020400>, WOS:001152894200001
- A60. Gheorghe Pristavu, Dan-Theodor Oneata, Razvan Pascu, Matei-Constantin Șerbănescu, Andrei Enache, Florin Draghici, Gheorghe Brezeanu, "Modeling forward characteristics of high temperature capable Schottky diodes- High-accuracy optimization methods", *2023 International Semiconductor Conference (CAS)*, pp.85-88, <https://doi.org/10.1109/CAS59036.2023.10303668>
- A61. G. Brezeanu, G. Pristavu, R. Pascu, F. Draghici, "Schottky diode on Silicon Carbide (SiC): ideal detector for very wide temperature range sensors," *Proc. SPIE 12493, Advanced Topics in Optoelectronics, Microelectronics, and Nanotechnologies XI*, 1249303 (2 March 2023), <https://doi.org/10.1117/12.2644249>
- A62. Boncu, M., Pana, S., Draghici, F., Brezeanu, G., "A second order discrete-time ΔA analog to digital converter for audio applications", in *2022 International Semiconductor Conference (CAS)*, pp. 209-212, IEEE. <https://doi.org/10.1109/CAS56377.2022.9934665>
- A63. Serbanescu, M., Nastase, F., Draghici, F., Pristavu, G., Catrina, E., Chiriac, R., Brezeanu, G., "Architecture for a Modular Temperature Detection System Used for Diabetic Foot Investigations", in *2022 International Semiconductor Conference (CAS)*, pp. 205-208, IEEE, <https://doi.org/10.1109/CAS56377.2022.9934331>
- A64. Pascu, R., Pristavu, G., Stoia, M., Romanitan, C., Kuskol, M., Draghici, F., Brezeanu, G., "The effect of forming gas annealing on Al/Ti/n-Si contacts", in *2022 International Semiconductor Conference (CAS)*, pp. 127-130, IEEE, <https://doi.org/10.1109/CAS56377.2022.9934472>
- A65. R. Pascu, G. Pristavu, M. Kusko, F. Draghici and G. Brezeanu, "Detecting anomalous behavior in Si MOS capacitors," *2021 International Semiconductor Conference (CAS)*, 2021, pp. 103-106, <https://doi.org/10.1109/CAS52836.2021.9604132>, WOS:000853482700019

- A66. G. -C. Ilie Chiranu, C. Tudoran, G. Pristavu, F. Draghici and G. Brezeanu, "Experimental Comparison of 8-bit Digitally Programmable Potentiometers based on Multistage Architectures," 2021 International Semiconductor Conference (CAS), 2021, pp. 205-208, <https://doi.org/10.1109/CAS52836.2021.9604161>, WOS:000853482700042
- A67. G.-C Ilie (Chiranu), C. Tudoran, O. Neagoie, F. Draghici, G. Brezeanu, "Nonvolatile Analog Switch for Low-Voltage Applications", *Electronics* 2021, 10(6), 736, <https://doi.org/10.3390/electronics10060736>, WOS:000634338200001, Q2 în Domeniul Engineering, Electrical & Electronic, FI=2,412 la data publicării.
- A68. M. Boncu, C. Botezatu, F. Draghici, "An algorithm-based method for accurate compensation of bandgap references over temperature", *Romanian Journal Of Information Science And Technology*, Volume 24, Number 2, 2021, pp. 143-160, <https://www.romjist.ro/full-texts/paper685.pdf>, WOS:000668010700002, Q2 în Domeniul Instruments & Instrumentation, FI=0,643 in 2022
- A69. R. Pascu, M. Danila, P. Varasteanu, M. Kusko, G. Pristavu, G. Brezeanu, F. Draghici, "Improved Ti/Pt/Au-n-Type Si Contacts by Post-Metallization Annealing in Nitrogen Atmosphere", in *Proc. of the 2018 International Semiconductor Conference (CAS)*, Sinaia, Romania, pp. 307-310, 2018, IEEE, DOI: [10.1109/SMICND.2018.8539839](https://doi.org/10.1109/SMICND.2018.8539839), WOS:000514386700064.
- A70. L. Teodorescu, F. Drăghici, I. Rusu, G. Brezeanu, "On Wafer High Temperature Characterization System", in *Proc. of the 8th International Conference on Advanced Topics in Optoelectronics, Microelectronics, and Nanotechnologies (ATOMN)*, SEP 25-28, 2016, Constanta, Romania, pp. 8, ISBN: 9781510604247; 9781510604254, ISSN: 0277786X, <https://doi.org/10.1117/12.2247062>, WOS:000391359600006
- A71. G. Pristavu, A. Vasilica, V. Anghel, R. Pascu, G. Brezeanu, F. Draghici, "High voltage freewheeling diodes in an extended capability LED driving application", in *Proc. of the 38th International Semiconductor Conference*, 12-14 Oct. 2015, Sinaia, Romania, pp.175 - 178, ISBN: 978-1-4799-8862-4, ISSN: 1545-827X, DOI: [10.1109/SMICND.2015.7355199](https://doi.org/10.1109/SMICND.2015.7355199), WOS:000380566400033.
- A72. F. Draghici, M. Pantazica, N. D. Codreanu, P. Svasta, "Hands on Project Key Issue in the Education of Future Electronic Engineers", *Proceedings of the 37th International Spring Seminar on Electronics Technology (ISSE) - Advances in Electronic System Integrations*, Book Series: International Spring Seminar on Electronics Technology ISSE, pp. 470-475, 2014, ISBN: 978-1-4799-4455-2, ISSN: 2161-2528, DOI: [10.1109/ISSE.2014.6887646](https://doi.org/10.1109/ISSE.2014.6887646), WOS:000346580500093.
- A73. A. B. Nae, G. Brezeanu, F. Draghici, "CMOS Current Reference With Improved Temperature Compensation", in *Proc. of the 36th International Semiconductor Conference (CAS)*, Oct. 14-16 2013, Sinaia, Romania, Vol.2, ISSN: 1545-827X, ISBN: 978-1-4673-5672-5; 978-1-4673-5670-1, DOI: [10.1109/SMICND.2013.6688683](https://doi.org/10.1109/SMICND.2013.6688683), WOS:000330180800059.
- A74. F. Draghici, I. Rusu, G. Brezeanu, M. Badila, C. Boianceanu, I. Enache, 'High Temperature Probe Based on SiC Schottky Diode for Hostile Environments', in the *Book of Abstracts - Smart Applications & Technologies for Electronic Engineering*, SATTEE 2010, 09 -11 September, 2010, Alba Iulia, Romania, pp.41-42, google academic la <http://www.satee.uab.ro/upts/ SATTEE2010.pdf#page=44>
- A75. F. Draghici, I. Rusu, G. Brezeanu, B. Bucur „An Accurate Method For Measuring Very Low Frequency Biosignals”, in *Proc. of the 32nd IEEE International Semiconductor Conference*, 12-14 Oct. 2009, Sinaia, Romania, pp. 423-426, ISSN: 1545-827X, ISBN: 978-1-4244-4413-7, DOI: [10.1109/SMICND.2009.5336688](https://doi.org/10.1109/SMICND.2009.5336688), WOS:000279558600085.
- A76. G. Brezeanu, F. Draghici, C. Boianceanu, "SiC Photodetectors with High UV Selectivity and Sensitivity", at The 3rd International Balkan Workshop On Applied Physics, 26-28 June, 2002, Tirgoviste, Romania, vizibil la http://www.nipne.ro/rjp/archive/contents_2003_48_1-4.pdf
- A77. M. Badila, G. Brezeanu, V. Banu, P. Godignon, J. Millan, X. Jorda, F. Draghici, "SiC power Schottky diodes industrial development", in *Proc. of the 24th IEEE International Semiconductor Conference*, 9-13 Oct., 2001, Sinaia, Romania, pp. 337 - 340, ISBN: 0-7803-6666-2, DOI: [10.1109/SMICND.2001.967478](https://doi.org/10.1109/SMICND.2001.967478), WOS:000175459600070.
- A78. F. Mitu, F. Draghici, G. Dilimot, G. Brezeanu, I. Enache, "GTO gating circuit by open cathode method", in *Proc. of the 20th International Semiconductor Conference*, 7-11 Oct. 1997, Sinaia, Romania, pp. 123-126, ISBN: 0-7803-3804-9, DOI: [10.1109/SMICND.1997.651562](https://doi.org/10.1109/SMICND.1997.651562), WOS:000072168800020.
- A79. P. Agache, C. Boianceanu, F. Draghici, G. Dilimot, G. Brezeanu, "Data Aquisition and Processing for Semiconductor Devices", in *Proc. of the 26th IEEE International Semiconductor Conference*, September 28-October 2, 2003, Sinaia, Romania, pp. 223 - 226, ISBN: 0-7803-7821-0, DOI: [10.1109/SMICND.2003.1252422](https://doi.org/10.1109/SMICND.2003.1252422), WOS:000189468100047.
- A80. L. Teodorescu, A. S. Gheorghe, F. Draghici, "Digital signage equipment for gas station pumps application", *U.P.B. Sci. Bull., Series C*, Vol. 75, Iss. 4, 2013, ISSN 2286 - 3540, pp. 57-68, B+, https://www.scientificbulletin.upb.ro/rev_docs_arhiva/full255_124795.pdf, SCOPUS.

B. Primele 50 de lucrări publicate în reviste cotate ISI, în ordinea descrescătoare a citărilor.

- B1. G. Brezeanu, G. Pristavu, F. Draghici, M. Badila, R. Pascu, "Characterization Technique for Inhomogeneous 4H-SiC Schottky Contacts: A Practical Model for High Temperature Behavior", *Journal of Applied Physics*, Vol. 122, Article Number: 084501, 2017, <https://doi.org/10.1063/1.4999296>, WOS:000409117200029, ISSN: 0021-8979, EISSN: 1089-7550, Q2 în Domeniul Physics, Applied, FI=2,546 anul 2022, 39 de citări

- B2. G. Brezeanu, F. Draghici, F. Craciunoiu, C. Boianeanu, F. Bernea, F. Udrea, D. Puscasu, I. Rusu, "4H-SiC Schottky Diodes for Temperature Sensing Applications in Harsh Environments", *Materials Science Forum*, Vols. 679-680, 2011, pp. 575-578, ISBN: 978-3-03785-079-4, <https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.679-680.575>, WOS:000291673500138, **Q4** în Domeniul Materials Science, Multidisciplinary, FI=0,399 la data publicării, 35 de citări
- B3. G. Pristavu, G. Brezeanu, R. Pascu, F. Drăghici, M. Bădilă, "Characterization of non-uniform Ni/4H-SiC Schottky diodes for improved responsivity in high-temperature sensing", *Materials Science in Semiconductor Processing*, Volume 94, 2019, Pages 64-69, ISSN 1369-8001, <https://doi.org/10.1016/j.mssp.2019.01.018>, WOS:000458507800009, **Q1** în Domeniul Engineering, Electrical & Electronic, FI=3,927 în 2022, 31 de citări
- B4. F. Draghici, G. Brezeanu, G. Pristavu, R. Pascu, M. Badila, A. Pribeanu, E. Ceuca, "400 °C sensor based on Ni/4H-SiC Schottky diode for reliable temperature monitoring in industrial environments", *Sensors*, 2019, 19, 2384, [HTTPS://DOI.ORG/10.3390/S19102384](https://doi.org/10.3390/S19102384), WOS:000471014500171, **Q1** în Domeniul Instruments & Instrumentation, FI=3,576 în 2022, 22 de citări
- B5. Pavel, R. Chiriac, A. Birtas, F. Draghici, M. Dinca, "On the improvement by laser ignition of the performances of a passenger car gasoline engine", *Optics Express*, Vol. 27, No. 8, 2019, <https://doi.org/10.1364/OE.27.00A385>, WOS:000464614400013, **Q1** în Domeniul Optics, FI=3,894 în 2022, 20 de citări.
- B6. R. Pascu, G. Pristavu, G. Brezeanu, F. Draghici, P. Godignon, C. Romanitan, M. Serbanescu, A. Tulbure, "60-700K CTAT and PTAT Temperature Sensors with 4H-SiC Schottky Diodes", *Sensors*, 2021, 21(3), 942; pp. 1-15, publicare online, eISSN: 1424-8220, <https://doi.org/10.3390/s21030942>, WOS:000615521900001, **Q1** în Domeniul Instruments & Instrumentation, FI=3,576 în 2022, 14 de citări
- B7. G. Brezeanu, F. Draghici, M. Badila, F. Craciunoiu, G. Pristavu, R. Pascu, F. Bernea, "Two Packaging Solutions for High Temperature SiC Diode Sensors", *Materials Science Forum*, cu titlul Silicon Carbide and Related Materials 2013 PTS 1 and 2, Vols. 778-780, 2014, pp. 1063-1066, ISSN: 0255-5476, <https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.778-780.1063>, WOS:000336634100253, **Q4** în Domeniul Materials Science, Multidisciplinary, FI=0,399 în 2022, 13 de citări
- B8. G. Brezeanu, G. Pristavu, F. Draghici, R. Pascu, F. Della Corte, S. Rascuna, "Enhanced Non-Uniformity Modeling of 4H-SiC Schottky Diode Characteristics Over Wide High Temperature and Forward Bias Ranges", *IEEE Journal of the Electron Devices Society*, Volume: 8, Pages: 1339-1344, 2020, DOI: 10.1109/JEDS.2020.3032799, ISSN: 2168-6734, WOS:000589593200001, **Q2** în Domeniul Engineering, Electrical & Electronic, FI=2,555 în 2022, 9 citări
- B9. A. Birtas, N. Boicea, G. Croitoru, M. Dinca, N. Pavel, F. Draghici, R. Chiriac, "On the possibility to improve petrol engine operation by laser ignition", *Energy Procedia*, Vol. 157, pp. 1022-1028, Elsevier, 2019, ISSN: 1876-6102, <https://doi.org/10.1016/j.egypro.2018.11.269>, WOS:000470998600112, 6 citări
- B10. G. Brezeanu, F. Draghici, M. Badila, I. Rusu, F. Bernea, P. Godignon, "A Fully Electrically Isolated Package for High Temperature SiC Sensors", *Materials Science Forum*, with title Silicon Carbide and Related Materials 2011, Vols. 717-720, 2012, 925-928, ISBN: 978-3-03785-419-8, <https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.717-720.925>, WOS:000309431000220, **Q4** în Domeniul Materials Science, Multidisciplinary, FI=0,399 în 2022, 5 citări
- B11. A. Enache, F. Draghici, F. Mitu, R. Pascu, G. Pristavu, M. Pantazica, G. Brezeanu, "PLL-Based Readout Circuit for SiC-MOS Capacitor Hydrogen Sensors in Industrial Environments", *Sensors* 2022, 22, 1462. <https://doi.org/10.3390/s22041462>, WOS:000769505800001, **Q1** în Domeniul Instruments & Instrumentation, FI=3,576 în 2022, 4 citări
- B12. F. Draghici, G. Brezeanu, I. Rusu, F. Bernea, P. Godignon, "High Temperature SiC Sensor With an Isolated Package", *Materials Science Forum*, 2013, with title Silicon Carbide and Related Materials 2012, vols. 740-742, ISBN: 978-3-03785-419-8, IDS: BFG56, <https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.740-742.1002>, WOS:000319785500239, **Q4** în Domeniul Materials Science, Multidisciplinary, FI=0,399 la data publicării, 4 citări
- B13. G.-C Ilie (Chiranu), C. Tudoran, O. Neagoe, F. Draghici, G. Brezeanu, "Nonvolatile Analog Switch for Low-Voltage Applications", *Electronics* 2021, 10(6), 736, <https://doi.org/10.3390/electronics10060736>, WOS:000634338200001, **Q2** în Domeniul Engineering, Electrical & Electronic, FI=2,412 la data publicării, 2 citări
- B14. R. Pascu, G. Pristavu, D. T. Oneata, M. Stoian, C. Romanitan, M. Kusko, F. Draghici, G. Brezeanu, "Enhanced Method of Schottky Barrier Diodes Performance Assessment", *ROMJIST*, Volume 26, No. 2, 2023, pp. 181-192, DOI: 10.59277/ROMJIST.2023.2.05 (<https://www.romjist.ro/full-texts/paper741.pdf>), WOS:001014842500006, 1 citare
- B15. Pascu R, Pristavu G, Oneata D-T, Brezeanu G, Romanitan C, Djourellov N, Enache A, Draghici F, Ivan AM, Ceuca E, "Thorough Wide-Temperature-Range Analysis of Pt/SiC and Cr/SiC Schottky Contact Non-Uniformity". *Materials*, 2024, 17(2):400. <https://doi.org/10.3390/ma17020400>, WOS:001152894200001
- B16. G.-C Ilie (Chiranu), C. Tudoran, O. Neagoe, F. Draghici, G. Brezeanu, "Nonvolatile Analog Switch for Low-Voltage Applications", *Electronics* 2021, 10(6), 736, <https://doi.org/10.3390/electronics10060736>, WOS:000634338200001, **Q2** în Domeniul Engineering, Electrical & Electronic, FI=2,412 la data publicării.
- B17. M. Boncu, C. Botezatu, F. Draghici, "An algorithm-based method for accurate compensation of bandgap references over temperature", *ROMJIST*, Volume 24, Number 2, 2021, pp. 143-160, <https://www.romjist.ro/full-texts/paper685.pdf>, WOS:000668010700002, **Q2** în Domeniul Instruments & Instrumentation, FI=0,643 în 2022

C. Lucrări publicate în Proceedings de conferințe cotate ISI.

- C1. G. Brezeanu, M. Badila, F. Draghici, R. Pascu, G. Pristavu, F. Craciunoiu, I. Rusu, "High temperature sensors based on silicon carbide (SiC) devices", in *Proc. of the 38th International Semiconductor Conference*, 12-14 Oct. 2015, Sinaia, Romania, pp. 3-10, ISBN: 978-1-4799-8862-4, ISSN: 1545-827X, DOI: [10.1109/SMICND.2015.7355147](https://doi.org/10.1109/SMICND.2015.7355147), WOS:000380566400001, 19 de citări
- C2. R. Pascu, F. Draghici, M. Badila, F. Craciunoiu, G. Brezeanu, A. Dinescu, I. Rusu, "High Temperature Sensor Based on SiC Schottky Diodes with Undoped Oxide Ramp Termination", in *Proc. of the 34th IEEE International Semiconductor Conference*, 17-19 Oct. 2011, Sinaia, Romania, Vol. 2, pp. 379-382, ISSN: 1545-827X, ISBN: 978-1-61284-171-7, DOI: [10.1109/SMICND.2011.6095823](https://doi.org/10.1109/SMICND.2011.6095823), WOS:000320322000086, 11 citări
- C3. F. Draghici, M. Badila, G. Brezeanu, I. Rusu, F. Craciunoiu, I. Enache, "An Industrial Temperature Probe Based on SiC Diodes", in *Proc. of the 33rd International Semiconductor Conference*, 11-13 Oct. 2010, Sinaia, Romania, vol. 2, pp. 409-412, ISBN: 978-1-4244-5971-6, ISSN: 1545-827X, DOI: [10.1109/SMICND.2010.5650596](https://doi.org/10.1109/SMICND.2010.5650596), WOS:000371396100084, 11 citări
- C4. F. Draghici, X. Jorda, G. Brezeanu, M. Badila, J. Millan, P. Godignon, "A System for Measure Reverse Recovery Time and Stored Charge at Ultrafast Power Diodes", in *Proc. of the 24th IEEE International Semiconductor Conference*, 9-13 Oct., 2001, Sinaia, Romania, pp. 473-476, ISBN: 0-7803-6666-2, DOI: [10.1109/SMICND.2001.967508](https://doi.org/10.1109/SMICND.2001.967508), WOS:000175459600100, 11 citări
- C5. R. Pascu, G. Pristavu, M. Badila, G. Brezeanu, F. Draghici, F. Craciunoiu, "Temperature Behavior of 4H- SiC MOS Capacitor Used as a Gas Sensor", in *Proc. of the 37th International Semiconductor Conference (CAS)*, 13-15 Oct. 2014, Sinaia, Romania, pp. 185-188, ISBN: 978-1-4799-3916-9, ISSN: 1545-827X, DOI: [10.1109/SMICND.2014.6966430](https://doi.org/10.1109/SMICND.2014.6966430), WOS:000380488300036, 10 citări
- C6. R. Pascu, F. Craciunoiu, M. Kusko, F. Draghici, A. Dinescu, M. Danila, "The Effect of the Post-Metallization Annealing of Ni/n-type 4H-SiC Schottky Contact", in *Proc. of the 35th IEEE International Semiconductor Conference*, 15-17 Oct. 2012, Sinaia, Romania, vol. 2, IEEE Catalog Number: CFP12CAS-PRT, ISBN: 978-1-4673-0736-9, ISSN: 1545-827X, pp. 457-460, DOI: [10.1109/SMICND.2012.6400732](https://doi.org/10.1109/SMICND.2012.6400732), WOS:000314223700095, 9 citări
- C7. F. Draghici, M. Badila, G. Brezeanu, G. Pristavu, I. Rusu, F. Craciunoiu, R. Pascu, "4H-SiC Schottky Contact Improvement for Temperature Sensor Applications", in *Proc. of the 36th International Semiconductor Conference (CAS)*, 14-16 oct. 2013, Sinaia, Romania, Vol. 2, ISBN:978-1-4673-5672-5; 978-1-4673-5670-1, ISSN: 1545-827X, DOI: [10.1109/SMICND.2013.6688645](https://doi.org/10.1109/SMICND.2013.6688645), WOS:000330180800033, 6 citări
- C8. L. Teodorescu, F. Draghici, G. Brezeanu, I. Rusu, "High Temperature Characterization System for Silicon Carbide Devices", in *Proc. of the 35th IEEE International Semiconductor Conference (CAS)*, Oct. 15-17 2012, Sinaia, Romania, Vol. 2, IEEE Catalog Number: CFP12CAS-PRT, ISBN: 978-1-4673-0736-9, ISSN: 1545-827X, pp. 449-452, DOI: [10.1109/SMICND.2012.6400734](https://doi.org/10.1109/SMICND.2012.6400734), WOS:000314223700093, 6 citări
- C9. M. Boncu, C. Botezatu, F. Draghici, "A precise method for compensating bandgap references over temperature", in *Proceedings of the 2020 International Semiconductor Conference (CAS)*, 7-9 Oct. 2020, Sinaia, Romania, pp. 245-248, eISBN:978-1-7281-1073-8, Print on Demand (PoD) ISBN:978-1-7281-1074-5, DOI: [10.1109/CAS50358.2020.9268045](https://doi.org/10.1109/CAS50358.2020.9268045), WOS:000637264600055, 4 citări
- C10. R.V. Petrica, M.D. Dobre, P. Coll, F. Draghici, G. Brezeanu, "Comparison of Level Shifter Architectures: Application to I/O Cell", in *Proc. of the 2018 International Semiconductor Conference (CAS)*, Sinaia, Romania, pp. 209-212, 2018, IEEE., DOI: [10.1109/SMICND.2018.8539796](https://doi.org/10.1109/SMICND.2018.8539796), WOS:000514386700041, 4 citări
- C11. A. Enache, I. Rusu, B. Bucur, F. Drăghici, G. Pristavu, M.P. Bucur, F. Enache, G. Brezeanu, "Experimental Characterization of a High Accuracy Amperometric Sense and Control Circuit for Three-Electrode Biosensors", in *Proc. of the 40th International Semiconductor Conference*, 11-14 Oct. 2017, Sinaia, Romania, pp.179-182, ISSN: 1545-827X, DOI: [10.1109/SMICND.2017.8101193](https://doi.org/10.1109/SMICND.2017.8101193), WOS:000425844500037, 4 citări
- C12. C. Ionescu, F. Drăghici, D. Bonfert, "A SPICE model for electroluminescent foils", in *Proc. of the 38th International Spring Seminar on Electronics Technology (ISSE)*, 6-10 May 2015, Eger, Hungary, pp: 526 - 531, ISSN: 2161-2528, DOI: [10.1109/ISSE.2015.7248057](https://doi.org/10.1109/ISSE.2015.7248057), WOS:000374113000105, 4 citări
- C13. A. Sevcenco, G. Brezeanu, M.Badila, F. Draghici, I. Rusu, A Visoreanu, "Experimental Validation of a Simple Analytical Model for the Electrical Behavior of Nanoscale MOSFETs", in *Proc. of the 30th IEEE International Semiconductor Conference*, 15-17 Oct. 2007, Sinaia, Romania, pp. 551-554, ISBN: 978-1-4244-0847-4, DOI: [10.1109/SMICND.2007.4519783](https://doi.org/10.1109/SMICND.2007.4519783), WOS:000255865200120, 4 citări
- C14. G. Brezeanu, M. Badila, M. Brezeanu, F. Udrea, C. Boianceanu, I. Enache, F. Draghici, A. Visoreanu, "Breakdown performances improvements of SiC diodes using high-k dielectrics", in *Proc. of the 28th IEEE International Semiconductor Conference*, 2-4 Oct., 2005, Sinaia, Romania, pp. 357-360, ISBN: 0-7803-9214-0, DOI: [10.1109/SMICND.2005.1558799](https://doi.org/10.1109/SMICND.2005.1558799), WOS:000237180300078, 4 citări
- C15. M. Badila, G. Brezeanu, V. Banu, P. Godignon, J. Millan, X. Jorda, F. Draghici, "SiC power Schottky diodes industrial development", in *Proc. of the 24th IEEE International Semiconductor Conference*, 9-13 Oct., 2001, Sinaia, Romania, pp. 337 - 340, ISBN: 0-7803-6666-2, DOI: [10.1109/SMICND.2001.967478](https://doi.org/10.1109/SMICND.2001.967478), WOS:000175459600070, 4 citări
- C16. A. Birtas, N. Boicea, F. Draghici, R. Chiriac, G. Croitoru, M. Dinca T. Dascalu, N. Pavel, "On the assessment of performance and emissions characteristics of a SI engine provided with a laser ignition system", in (CAR2017) Book Series: IOP Conference Series-Materials Science and Engineering, Volume: 252, 2017, ISSN: 1757-8981, DOI: [http://dx.doi.org/10.1088/1757-899X/252/1/012071](https://doi.org/http://dx.doi.org/10.1088/1757-899X/252/1/012071), WOS:000419817200071, 3 citări
- C17. G. Pristavu, F. Draghici, G. Brezeanu, R. Pascu, F. Craciunoiu, "High Temperature SiC-Sensors", IEEE 20th International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging, SIITME 2014 - Conference

- Proceedings, pp. 329-332, Bucuresti, Romania, 23 - 26 October 2014, ISBN: 978-1-4799-6962-3, DOI: [10.1109/SIITME.2014.6967024](https://doi.org/10.1109/SIITME.2014.6967024), WOS:000358258300061, 3 citări
- C18. B. Ofrim, G. Brezeanu, F. Draghici, I. Rusu, "High Temperature Hydrogen Sensor based on Silicon Carbide (SiC) MOS Capacitor Structure", Proceedings with Abstracts (two pages) of the International Conference on Silicon Carbide and Related Materials (ICSCRM2013), September 29 - October 4, 2013, Phoenix Seagaia Resort, Miyazaki, Japan, ISBN 978-4-86348-378-1, publicat ca abstract de 2 pagini in Proceedings-ul Conferintei ICSCRM2013 și selectionat pentru publicare in extenso in Materials Science Forum 2014, ISI, http://icscrm2013.org/index.php?plugin=attach&refer=program&openfile=ICSCRM2013_Technical_Program_1004Final.pdf, 3 citări
- C19. G. Brezeanu, A. Sevcenco, C. Boianceanu, I. Rusu, F. Draghici, „A Complete Analytical Submicron MOS Transistor Drain Model for Analog Applications”, in Proc. of the 31th IEEE International Semiconductor Conference, 13-15 Oct. 2008, Sinaia, Romania, pp. 309-312, ISBN: 978-1-4244-2004-9, DOI: [10.1109/SMICND.2008.4703411](https://doi.org/10.1109/SMICND.2008.4703411), WOS:000267590800063, 3 citări
- C20. G. Brezeanu, A. Visoreanu, M. Brezeanu, F. Udrea, G. A. J. Amaratunga, I. Enache, I. Rusu, F. Draghici, "OFF-State performance of Ideal Schottky Barrier Diodes (SBD) on Diamond and Silicon Carbide", in Proc. of the 29th IEEE International Semiconductor Conference, 27-29 Sept. 2006, Sinaia, Romania, pp. 319-322, ISBN: 1-4244-0109-7, DOI: [10.1109/SMICND.2006.284008](https://doi.org/10.1109/SMICND.2006.284008), WOS:000243090700066, 3 citări
- C21. M. Badila, G. Brezeanu, J. P. Chante, Marie-Laure Locatelli, J. Millan, P. Godignon, P. Lungu, F. Mitu, F. Draghici, F. J. Campos, A. Lebedev, V. Banu, G. Banoiu, "A Technique To Avoid Micropipe Effects on 6H-SiC Power Devices", in Proc. of the 22nd International Semiconductor Conference, 5-9 Oct., 1999, Sinaia, Romania, pp. 187 - 190, IEEE Catalog Number: 99TH8389, ISBN: 0-7803-513 9-8 Softbound Edition, 0-7803-5140-1 Microfiche Edition, IEEE - IEEExplore, DOI: [10.1109/SMICND.1999.810459](https://doi.org/10.1109/SMICND.1999.810459), <http://ieeexplore.ieee.org>, 3 citări
- C22. M. Gheorghe, P. Mugur Svasta, S. Gheorghe, C. Ionescu, F. Draghici, "Organic Electrical Passive Components Based on Polyaniline", 2020 IEEE 8th Electronics System-Integration Technology Conference (ESTC), 15-18 Sept. 2020, Tønsberg, Vestfold, Norway, ISBN:978-1-7281-6293-5, ISBN:978-1-7281-6294-2, DOI: [10.1109/ESTC48849.2020.9229672](https://doi.org/10.1109/ESTC48849.2020.9229672), WOS: 000631824100013, 2 citări
- C23. A. Enache, F. Drăghici, G. Pristavu, G. Brezeanu, "Voltage Controlled Oscillator for Small-Signal Capacitance Sensing", in Proceedings of the 2019 International Semiconductor Conference (CAS), Sinaia, Romania, 9-11 Oct. 2019, DOI: [10.1109/SMICND.2019.8923728](https://doi.org/10.1109/SMICND.2019.8923728), WOS:000514295300068, 2 citări
- C24. N. Pavel, R. Chiriac, A. Birtas, N. Boicea, F. Draghici, G. Croitoru, M. Dinca, "Lean-Mixture Operation of a Passenger Car Gasoline Engine Ignited by Passively Q-switched Nd: YAG/Cr4+: YAG Laser Spark Plugs", in 2019 Conference on Lasers and Electro-Optics Europe and European Quantum Electronics Conference, OSA Technical Digest (Optical Society of America, 2019), paper cm_p_13., ISBN:978-1-7281-0469-0, DOI: [10.1109/CLEOE-EQEC.2019.8872741](https://doi.org/10.1109/CLEOE-EQEC.2019.8872741), WOS:000630002701062, 2 citări.
- C25. A. Enache, I. Rusu, F. Drăghici, Gh. Brezeanu, Gh. Pristavu, F. Enache, "Smart Sensor For Chemical Compounds Concentration", in Proc. of the 39th International Semiconductor Conference, 10-12 Oct. 2016, Sinaia, Romania, pp.201-204, ISBN: 9781509012077, ISSN: 1545827X, DOI: [10.1109/SMICND.2016.7783086](https://doi.org/10.1109/SMICND.2016.7783086), WOS:000391323300041.
- C26. N. Bădălan, P. Svasta, F. Drăghici, "Constant current versus pulse current for power supplies on high power LED", in Proc. of the 21st International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging (SIITME), 2015 IEEE, 22-25 Oct. 2015, Brasov, Romania, pp. 263 - 266, DOI: [10.1109/SIITME.2015.7342337](https://doi.org/10.1109/SIITME.2015.7342337), WOS:000377765500049.
- C27. G. Brezeanu, F. Udrea, A. Mihaila, G. Amaratunga, J. Millan, P. Godignon, M. Badila, F. Draghici, C. Boianceanu, M. Brezeanu, "Numerical and Analytical Study of 6H-SiC Detectors with High UV Performance", in Proc. of the 25th IEEE International Semiconductor Conference, 2002, Sinaia, Romania, pp. 185-188, ISBN: 0-7803-7440-1, DOI: [10.1109/SMICND.2002.1105827](https://doi.org/10.1109/SMICND.2002.1105827), WOS:000181629400039, 2 citări
- C28. F. Draghici, F. Mitu, G. Brezeanu, M. Badila, C. Boianceanu, P. Agache, I. Enache, "Electrical and Optical Behavior of the SiC Photodetectors", in Proc. of the 25th IEEE International Semiconductor Conference, 8-12 Oct., 2002, Sinaia, Romania, pp.195 -198, ISBN: 0-7803-7440-1, DOI: [10.1109/SMICND.2002.1105829](https://doi.org/10.1109/SMICND.2002.1105829), WOS:000181629400041, 2 citări
- C29. F. Mitu, F. Draghici, G. Dilimot, C. Amitroaie, I. Vladan, "A Characterisation Technique for High Power/Temperature Devices Using HP4275/3437 Systems", in Proc. of the 23rd IEEE International Semiconductor Conference, 10-14 Oct. 2000, Sinaia, Romania, pp. 337-340, ISBN: 0-7803-5885-6, DOI: [10.1109/SMICND.2000.890251](https://doi.org/10.1109/SMICND.2000.890251), WOS:000168560900068, 2 citări
- C30. F. Draghici, F. Mitu, G. Dilimot, I. Enache, "Method to increase the thermal stability of the heating circuits", in Proc. of the 21st International Semiconductor Conference, 6-10 Oct. 1998, Sinaia, Romania, pp. 501-504, ISBN: 0-7803-4432-4, [10.1109/SMICND.1998.733795](https://doi.org/10.1109/SMICND.1998.733795), WOS:000078772400094, 2 citări
- C31. Moise, V., Draghici, F., Pristavu, G., Pascu, R., Oneata, D. T., & Brezeanu, G. (2022, October), "Intelligent Temperature Sensor with SiC Schottky Diode", Proc. of the 2022 International Semiconductor Conference (CAS)", pp. 123-126, IEEE. <https://doi.org/10.1109/CAS56377.2022.9934369>, 1 citare
- C32. N. Pavel, G. Croitoru, O.V. Grigore, N.T Vasile, T. Dascalu, A. Birtas, N. Boicea, M. Dinca, F. Draghici, and R. Chiriac. "Laser spark-plug development: from experimental device to successful engine ignition", in Advances in 3OM: Opto-Mechatronics, Opto-Mechanics, and Optical Metrology, vol. 12170, pp. 185-192. SPIE, 2022, <https://doi.org/10.1117/12.2620045>, WOS:000838058200021, 1 citare

- C33. A. Enache, I. Rusu, B. Bucur, F. Drăghici, G. Pristavu, M.P. Bucur, F. Enache, G. Brezeanu, "Experimental Characterization of a High Accuracy Amperometric Sense and Control Circuit for Three-Electrode Biosensors", in *Proc. of the 40th International Semiconductor Conference*, 11-14 Oct. 2017, Sinaia, Romania, pp.179-182, ISSN: 1545-827X, ISBN: 978-1-5090-3985-2, DOI: [10.1109/SMICND.2017.8101193](https://doi.org/10.1109/SMICND.2017.8101193), WOS:000425844500037, 1 citare
- C34. G. Pristavu, G. Brezeanu, R. Pascu, F. Draghici, M. Badila, I. Rusu, "Study on thermal sensitivity of highly inhomogeneous Ni/4H-SiC Schottky diode over a wide temperature range", in *Proc. of the 40th International Semiconductor Conference*, 11-14 Oct. 2017, Sinaia, Romania, pp. 255-256, ISSN: 1545-827X, ISBN: 978-1-5090-3985-2, DOI: [10.1109/SMICND.2017.8101216](https://doi.org/10.1109/SMICND.2017.8101216), WOS:000425844500056, 1 citare
- C35. G. Pristavu, G. Brezeanu, F. Draghici, "Two parameter extraction solutions for high temperature SiC Schottky diodes - Converging to reality", in *Proc. of the IEEE 19th International Symposium for Design and Technology in Electronic Packaging (SIITME)*, Oct. 24-27, 2013, pp:181-184, ISBN:978-1-4799-1555-2, DOI: [10.1109/SIITME.2013.6743669](https://doi.org/10.1109/SIITME.2013.6743669), WOS:000347562900030, 1 citare
- C36. C. Boianceanu, G. Brezeanu, F. Udrea, G. Amaratunga, M. Brezeanu, A. Mihaila, F. Draghici, I. Enache, A. Visoreanu, "SiC Device Parameters Effects on the Electrical Behaviour of mCascode Switch", in *Proc. of the 27th International Semiconductor Conference*, 4-6 Oct., 2004, Sinaia, Romania, pp. 389-392, ISBN: 0-7803-8499-7, DOI: [10.1109/SMICND.2004.1403026](https://doi.org/10.1109/SMICND.2004.1403026), WOS:000228010700079, 1 citare
- C37. R. Pascu, G. Pristavu, M. Kusko, F. Draghici and G. Brezeanu, "Detecting anomalous behavior in Si MOS capacitors," 2021 International Semiconductor Conference (CAS), 2021, pp. 103-106, <https://doi.org/10.1109/CAS52836.2021.9604132>, WOS:000853482700019
- C38. G. -C. Ilie Chiranu, C. Tudoran, G. Pristavu, F. Draghici and G. Brezeanu, "Experimental Comparison of 8-bit Digitally Programmable Potentiometers based on Multistage Architectures," 2021 International Semiconductor Conference (CAS), 2021, pp. 205-208, <https://doi.org/10.1109/CAS52836.2021.9604161>, WOS:000853482700042
- C39. R. Pascu, M. Danila, P. Varasteanu, M. Kusko, G. Pristavu, G. Brezeanu, F. Draghici, "Improved Ti/Pt/Au-n-Type Si Contacts by Post-Metallization Annealing in Nitrogen Atmosphere", in *Proc. of the 2018 International Semiconductor Conference (CAS)*, Sinaia, Romania, pp. 307-310, 2018, IEEE, DOI: [10.1109/SMICND.2018.8539839](https://doi.org/10.1109/SMICND.2018.8539839), WOS:000514386700064.
- C40. L. Teodorescu, F. Drăghici, I. Rusu, G. Brezeanu, "On Wafer High Temperature Characterization System", in *Proc. of the 8th International Conference on Advanced Topics in Optoelectronics, Microelectronics, and Nanotechnologies (ATOMN)*, SEP 25-28, 2016, Constanta, Romania, pp. 8, ISBN: 9781510604247; 9781510604254, ISSN: 0277786X, <https://doi.org/10.1117/12.2247062>, WOS:000391359600006
- C41. G. Pristavu, A. Vasilica, V. Anghel, R. Pascu, G. Brezeanu, F. Draghici, "High voltage freewheeling diodes in an extended capability LED driving application", in *Proc. of the 38th International Semiconductor Conference*, 12-14 Oct. 2015, Sinaia, Romania, pp.175 - 178, ISBN: 978-1-4799-8862-4, ISSN: 1545-827X, DOI: [10.1109/SMICND.2015.7355199](https://doi.org/10.1109/SMICND.2015.7355199), WOS:000380566400033.
- C42. F. Draghici, M. Pantazica, N. D. Codreanu, P. Svasta, "Hands on Project Key Issue in the Education of Future Electronic Engineers", *Proceedings of the 37th International Spring Seminar on Electronics Technology (ISSE) - Advances in Electronic System Integrations*, Book Series: International Spring Seminar on Electronics Technology ISSE, pp. 470-475, 2014, ISBN: 978-1-4799-4455-2, ISSN: 2161-2528, DOI: [10.1109/ISSE.2014.6887646](https://doi.org/10.1109/ISSE.2014.6887646), WOS:000346580500093.
- C43. A. B. Nae, G. Brezeanu, F. Draghici, "CMOS Current Reference With Improved Temperature Compensation", in *Proc. of the 36th International Semiconductor Conference (CAS)*, Oct. 14-16 2013, Sinaia, Romania, Vol.2, ISSN: 1545-827X, ISBN: 978-1-4673-5672-5; 978-1-4673-5670-1, DOI: [10.1109/SMICND.2013.6688683](https://doi.org/10.1109/SMICND.2013.6688683), WOS:000330180800059.
- C44. F. Draghici, I. Rusu, G. Brezeanu, B. Bucur, "An Accurate Method For Measuring Very Low Frequency Biosignals", in *Proc. of the 32nd IEEE International Semiconductor Conference*, 12-14 Oct. 2009, Sinaia, Romania, pp. 423-426, ISSN: 1545-827X, ISBN: 978-1-4244-4413-7, DOI: [10.1109/SMICND.2009.5336688](https://doi.org/10.1109/SMICND.2009.5336688), WOS:000279558600085.
- C45. M. Badila, G. Brezeanu, V. Banu, P. Godignon, J. Millan, X. Jorda, F. Draghici, "SiC power Schottky diodes industrial development", in *Proc. of the 24th IEEE International Semiconductor Conference*, 9-13 Oct., 2001, Sinaia, Romania, pp. 337 - 340, ISBN: 0-7803-6666-2, DOI: [10.1109/SMICND.2001.967478](https://doi.org/10.1109/SMICND.2001.967478), WOS:000175459600070.
- C46. F. Mitu, F. Draghici, G. Dilimot, G. Brezeanu, I. Enache, "GTO gating circuit by open cathode method", in *Proc. of the 20th International Semiconductor Conference*, 7-11 Oct. 1997, Sinaia, Romania, pp. 123-126, ISBN: 0-7803-3804-9, DOI: [10.1109/SMICND.1997.651562](https://doi.org/10.1109/SMICND.1997.651562), WOS:000072168800020.
- C47. P. Agache, C. Boianceanu, F. Draghici, G. Dilimot, G. Brezeanu, "Data Aquisition and Processing for Semiconductor Devices", in *Proc. of the 26th IEEE International Semiconductor Conference*, September 28-October 2, 2003, Sinaia, Romania, pp. 223 - 226, ISBN: 0-7803-7821-0, DOI: [10.1109/SMICND.2003.1252422](https://doi.org/10.1109/SMICND.2003.1252422), WOS:000189468100047.

D. Lucrări publicate în *Proceedings* unor conferințe naționale și internaționale.

- D1. G. Pristavu, G. Brezeanu, M. Badila, F. Draghici, R. Pascu, F. Craciunoiu, I. Rusu, A. Pribeanu, "Barrier Stability of Pt/4H-SiC Schottky Diodes Used for High Temperature Sensing", *Materials Science Forum*, Vol. 897, cu titlul - Silicon Carbide and Related Materials 2016, pp. 606-609, May 2017, ISSN: 02555476, ISBN: 978-303571043-4, <https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.897.606>, 11 citări
- D2. R. Pascu, G. Pristavu, G. Brezeanu, F. Draghici, M. Badila, I. Rusu, F. Craciunoiu, "Electrical Characterization of Ni-Silicide Schottky Contacts on SiC for High Performance Temperature Sensor", *Materials Science Forum*, Vols. 821-823, pp. 436-439, 2015, [Scopus, INSPEC], <https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.821-823.436>, 5 citări.
- D3. G. Pristavu, G. Brezeanu, M. Badila, F. Draghici, R. Pascu, F. Craciunoiu, I. Rusu, A. Pribeanu, "High Temperature Behavior Prediction Techniques for Non-Uniform Ni/SiC Schottky Diodes", *Materials Science Forum*, Vol. 924, pp. 967-970, 2018, Trans Tech Publication, <https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.924.967>, [Scopus, INSPEC], 3 citări
- D4. G. Pristavu, G. Brezeanu, M. Badila, F. Draghici, R. Pascu, F. Craciunoiu, "An Investigation of SiC Schottky Contact Barrier Inhomogeneity for Temperature Sensing Applications", *Materials Science Forum*, Vol. 858, pp. 577-581, 2016, Trans Tech Publication, <https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.858.577>, [Scopus, INSPEC], 3 citări
- D5. *Sensor based on Silicon Carbide (SiC) MOS Capacitor Structure*, Proceedings with Abstracts (two pages) of the International Conference on Silicon Carbide and Related Materials (ICSCRM2013), September 29 - October 4, 2013, Phoenix Seagaia Resort, Miyazaki, Japan, ISBN 978-4-86348-378-1, publicat ca abstract de 2 pagini in Proceedings-ul Conferintei ICSCRM2013 și selectionat pentru publicare in extenso in Materials Science Forum 2014, ISI, <http://icscrm2013.org/index.php?plugin=attach&refer=>
- D6. M. Badila, G. Brezeanu, J. P. Chante, Marie-Laure Locatelli, J. Millan, P. Godignon, P. Lungu, F. Mitu, F. Draghici, F. J. Campos, A. Lebedev, V. Banu, G. Banoiu, "A Technique To Avoid Micropipe Effects on 6H-SiC Power Devices", in Proc. of the 22nd International Semiconductor Conference, 5-9 Oct., 1999, Sinaia, Romania, pp. 187 - 190, IEEE Catalog Number: 99TH8389, ISBN: 0-7803-513 9-8 Softbound Edition, 0-7803-5140-1 Microfiche Edition, IEEE - IEEEXplore, DOI: [10.1109/SMICND.1999.810459](http://ieeexplore.ieee.org), <http://ieeexplore.ieee.org>, 3 citări
- D7. F. Draghici, B. Ofri, G. Brezeanu, F. Mitu, F. Bernea, "High Temperature Automatic Characterization System For Semiconductor Devices", *Annals of the Academy of Romanian Scientists*, Vol.4, 2011, pp. 51-64, ISSN 2066-8562, http://www.aos.ro/site_mod/Publicatii/2011/AnaleINFOnr2pe2011.pdf, și Indexare Google Scholar, 2 citări
- D8. Moise, V., Draghici, F., Pristavu, G., Pascu, R., Oneata, D. T., & Brezeanu, G. (2022, October), "Intelligent Temperature Sensor with SiC Schottky Diode", *Proc. of the 2022 International Semiconductor Conference (CAS)*, pp. 123-126, IEEE. <https://doi.org/10.1109/CAS56377.2022.9934369>, 1 citare
- D9. Brezeanu, I. B., Botezatu, C., Drăghici, F., & Brezeanu, G. "Improved SPI Controlled, Low-Voltage, High Speed, Multi-Channel Switch", in 2022 14th International Conference on Electronics, Computers and Artificial Intelligence (ECAI) (pp. 1-4). IEEE. DOI: [10.1109/ECAI54874.2022.9847444](https://doi.org/10.1109/ECAI54874.2022.9847444), 1 citare
- D10. Gheorghe Pristavu, Dan-Theodor Oneata, Razvan Pascu, Matei-Constantin Șerbănescu, Andrei Enache, Florin Draghici, Gheorghe Brezeanu, "Modeling forward characteristics of high temperature capable Schottky diodes- High-accuracy optimization methods", 2023 International Semiconductor Conference (CAS), pp.85-88, <https://doi.org/10.1109/CAS59036.2023.10303668>
- D11. G. Brezeanu, G. Pristavu, R. Pascu, F. Draghici, "Schottky diode on Silicon Carbide (SiC): ideal detector for very wide temperature range sensors," *Proc. SPIE 12493, Advanced Topics in Optoelectronics, Microelectronics, and Nanotechnologies XI*, 1249303 (2 March 2023), <https://doi.org/10.1117/12.2644249>
- D12. Boncu, M., Pana, S., Draghici, F., Brezeanu, G., "A second order discrete-time ΔA analog to digital converter for audio applications", in 2022 International Semiconductor Conference (CAS), pp. 209-212, IEEE. <https://doi.org/10.1109/CAS56377.2022.9934665>
- D13. Șerbănescu, M., Nastase, F., Draghici, F., Pristavu, G., Catrina, E., Chiriac, R., Brezeanu, G., "Architecture for a Modular Temperature Detection System Used for Diabetic Foot Investigations", in 2022 International Semiconductor Conference (CAS), pp. 205-208, IEEE, <https://doi.org/10.1109/CAS56377.2022.9934331>
- D14. Pascu, R., Pristavu, G., Stoia, M., Romanitan, C., Kuskol, M., Draghici, F., Brezeanu, G., "The effect of forming gas annealing on Al/Ti/n-Si contacts", in 2022 International Semiconductor Conference (CAS), pp. 127-130, IEEE, <https://doi.org/10.1109/CAS56377.2022.9934472>
- D15. F. Draghici, I. Rusu, G. Brezeanu, M. Badila, C. Boianescu, I. Enache, 'High Temperature Probe Based on SiC Schottky Diode for Hostile Environments', in the Book of Abstracts - Smart Applications & Technologies for Electronic Engineering, SATEE 2010, 09 -11 September, 2010, Alba Iulia, Romania, pp.41-42, google academic la <http://www.satee.uab.ro/ups/ SATEE2010.pdf#page=44>
- D16. L. Teodorescu, A. S. Gheorghe, F. Draghici, "Digital signage equipment for gas station pumps application", *U.P.B. Sci. Bull., Series C*, Vol. 75, Iss. 4, 2013, ISSN 2286 - 3540, pp. 57-68, B+, https://www.scientificbulletin.upb.ro/rev_docs_arhiva/full255_124795.pdf, SCOPUS.

E. Cărți și capitole din cărți publicate la edituri din străinătate.

F. Cărți și capitole din cărți publicate la edituri din țară.

- F1. F. Drăghici, "Amplificatoare. Noțiuni de proiectare", Editura Matrix Rom, București, 2021, ISBN 978-606-25-0665-0, 111 pagini.
- F2. G. Brezeanu, F. Drăghici, "Circuite Electronice Fundamentale", Editura Niculescu, București, 2013, ISBN 978-973-748-745-2, 314 pagini.
- F3. F. Drăghici, I. Rusu, L. Teodorescu, "Circuite Electronice - Îndrumar de Laborator", Editura Hamangiu, București, 2016, ISBN 978-606-27-0397-4, 86 pagini.
- F4. I. Rusu, F. Babarada, F. Drăghici, "Dispozitive Electronice - Îndrumar de Laborator", Editura Rosetti Educațional, București, 2011, ISBN 978-973-7881-71-7, 108 pagini.
- F5. G. Brezeanu, F. Drăghici, F. Mitu, G. Dilimoț, "Circuite electronice fundamentale - probleme", Editura Rosetti Internațional, București, ediția III-2014, ISBN 978-973-8270-24-4, 3 ediții (2005, 2008, 2014), 169 pagini.
- F6. G. Brezeanu, F. Drăghici, F. Mitu, G. Dilimoț, "Dispozitive electronice - probleme", Editura Rosetti Educațional, București, 2009, ISBN 978-973-7881-57-1, 4 ediții (2001, 2004, 2006, 2009), 207 pagini.

G. Brevete internaționale, indicând toate datele oficiale de identificare

H. Brevete naționale, indicând toate datele oficiale de identificare.

H1. F. Drăghici, F. Mitu, "Interfață analogică", Brevet de invenție, Nr. 122980 / 28.05.2010, Oficiul de Stat Pentru Invenții și Mărci (OSIM), România, Derwent Primary Accession Number: 2010-K27053 [53] în baza ISI, https://ro.espacenet.com/publicationDetails/biblio?FT=D&date=20100528&DB=ro.espacenet.com&locale=ro_RO&CC=RO&NR=122980B1&KC=B1&ND=5.

I. Director de proiecte de cercetare internaționale (titlu, nr. proiect, contractor, suma).

J. Director de proiecte de cercetare naționale (titlu, nr. proiect, contractor, suma).

J.1 PN-III-P1-1.2-PCCDI2017-0419, autoritatea contractantă - CNDI- UEFISCDI, "Senzori și sisteme integrate electronice și fotonice pentru securitatea persoanelor și a infrastructurilor (SENSI)", Proiectul component P2: "Senzori de hidrocarburi pe SiC pentru securitatea în exploatare în medii industriale ostile, SiC-SENS", derulare: 2017-2021, Responsabil din partea UPB pe proiectul component P2: Florin Drăghici, - Suma totală 5047474 lei din care partener P2, UPB, 430000 lei.

J.2 Parteneriate în domeniile prioritare, Programului 4, direcția de cercetare 1.7.5, GIGASABAR, autoritatea contractantă - Centrul Național de Management Programe - CNMPme - CNMP, "Rezonatori de tip SAW și FBAR dedicați aplicațiilor în comunicații pentru gama 2-6GHz și în domeniul senzorilor, obținuți prin tehnici de microprelucrare și nanoprosesare a semiconductoarelor de bandă largă GaN și AlN", derulare: 2007-2010, Responsabil din partea UPB, Florin Drăghici, <http://www.imt.ro/gigasabar/>. - Suma totală 816016,70 lei din care partener P2, UPB, 31185 lei.

16.02.2024

Florin DRĂGHICI